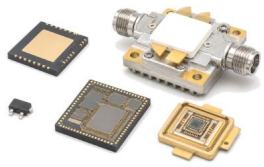
产品分类目录

射频 IC、MMIC 与半导体器件

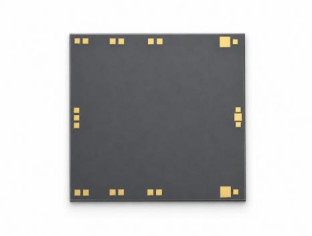
覆盖放大、变频、开关、检测、控制和频率生成等功能的射频半导体器件族；按工程功能组织，具体型号性能仍由受控证据确认。

产品: 315

版本: 16 · 修订日期: 2026-11-12



RF MMIC 放大器



LCI-PA-11500-18000-PS44p5T

11500–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

用于 11.5–18 GHz 微波发射链路的 GaN MMIC 功率放大器裸片。支持连续波和脉冲工作，射频输入与输出通路均内置隔直结构。

工作频率: 符号: f; 最小值: 11500; 最大值: 18000; 数值: 11500–18000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 44; 典型值: 44.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 19; 典型值: 19.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-14000-18000-PS42p5T

14000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

饱和输出功率: 42 dBm (最小值) / 42.5 dBm (典型值); 功率增益: 22 dB (最小值) / 22.5 dB (典型值); 功率附加效率: 35 % (最小值). 裸片尺寸: 3 × 2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

饱和输出功率: 最小值: 42; 典型值: 42.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 22; 典型值: 22.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 典型值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-14200-16800-PS48T

14200–16800 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 48 dBm (典型值); 功率增益: 20 dB (典型值); PAE: 35 % (典型值). 裸片尺寸: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 14200; 最大值: 16800; 数值: 14200–16800; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 48; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.35; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-14500-17200-PS48T

14500–17200 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 48 dBm (典型值); 功率增益: 20 dB (典型值); PAE: 35 % (典型值). 裸片尺寸: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 14500; 最大值: 17200; 数值: 14500–17200; 单位: MHz

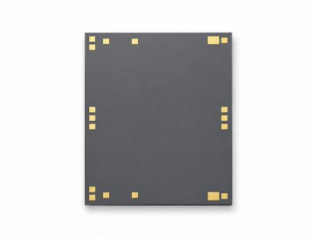
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 48; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.35; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-13750-14500-PS45MIN

13750–14500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 45 dBm (最小值); 功率增益: 20 dB (最小值); PAE: 37 % (最小值) / 38 % (典型值). 裸片尺寸: 2.8 × 3.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 13750; 最大值: 14500; 数值: 13750–14500; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.08 V; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-13750-15250-PS46T

13750–15250 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

饱和输出功率: 46 dBm (典型值); 功率增益: 21 dB (典型值); 功率附加效率: 33 % (典型值). 裸片尺寸: 5 × 6 × 0.08 mm.

工作频率: 最小值: 13750; 最大值: 15250; 数值: 13750–15250; 单位: MHz

饱和输出功率: 典型值: 46; 单位: dBm

功率增益: 典型值: 21; 单位: dB

功率增益平坦度: 最大值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS48p5T

8000–12000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

饱和输出功率: 48 dBm (最小值) / 48.5 dBm (典型值); 功率增益: 23 dB (最小值) / 23.5 dB (典型值); 功率附加效率: 44 % (典型值). 裸片尺寸: 4 × 5.8 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

饱和输出功率: 最小值: 48; 典型值: 48.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 23; 典型值: 23.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-13800-18200-PS47p5T

13800–18200 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 47 dBm (最小值) / 47.5 dBm (典型值); 功率增益: 21 dB (最小值) / 21.5 dB (典型值); PAE: 33 % (典型值). 裸片尺寸: 3.6 × 5.9 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 13800; 最大值: 18200; 数值: 13800–18200; 单位: MHz

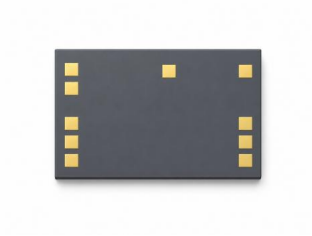
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 47; 典型值: 47.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 21; 典型值: 21.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-14000-18000-PS37p5T

14000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 37 dBm (最小值) / 37.5 dBm (典型值); 功率增益: 15 dB (最小值) / 15.5 dB (典型值); PAE: 35 % (典型值). 裸片尺寸: 1.5 × 1 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 37; 典型值: 37.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 15; 典型值: 15.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-12200-16000-PS46p5T

12200–16000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 46 dBm (最小值) / 46.5 dBm (典型值); 功率增益: 19 dB (最小值) / 19.5 dB (典型值); PAE: 33 % (典型值). 裸片尺寸: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 12200; 最大值: 16000; 数值: 12200–16000; 单位: MHz

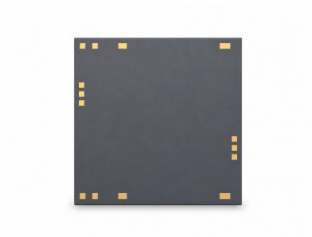
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 46; 典型值: 46.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 19; 典型值: 19.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-26000-40000-PS40p5T

26000–40000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

功率增益: 15 dB (典型值); PSAT: 40.5 dBm (典型值); PAE: 23 % (典型值). 裸片尺寸: 3.4 × 3.4 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 26000; 最大值: 40000; 数值: 26000–40000; 单位: MHz

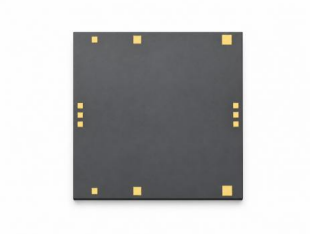
小信号增益: 符号: S21; 典型值: 22; 单位: dB

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 15; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.8 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-31000-37000-PS41T

31000–37000 MHz MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 41 dBm (典型值); PAE: 26 % (典型值); 小信号增益: 21 dB (典型值). 裸片尺寸: 3.6 × 3.6 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 31000; 最大值: 37000; 数值: 31000–37000; 单位: MHz

小信号增益: 符号: S21; 典型值: 21; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±1; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 41; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 1 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-33000-37000-PS45T

33000–37000 MHz MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 45 dBm (典型值); PAE: 22 % (典型值); 小信号增益: 23 dB (典型值). 裸片尺寸: 3.6 × 6.2 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 33000; 最大值: 37000; 数值: 33000–37000; 单位: MHz

小信号增益: 符号: S21; 典型值: 23; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±1; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 45; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.1 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-18000-40000-PS40p5T

18000–40000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 40.5 dBm (典型值); PAE: 15 % (典型值); 小信号增益: 21 dB (典型值). 裸片尺寸: 3.4 × 4.2 × 0.05 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 18000; 最大值: 40000; 数值: 18000–40000; 单位: MHz

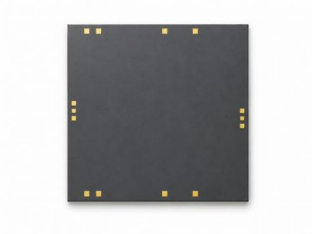
小信号增益: 符号: S21; 典型值: 21; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±1; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 40.5; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 2.2 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-92000-96000-PS36T

92000–96000 MHz MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 36 dBm (典型值); PAE: 9 % (典型值); 小信号增益: 19 dB (典型值). 裸片尺寸: 5.1 × 5.1 × 0.05 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 92000; 最大值: 96000; 数值: 92000–96000; 单位: MHz

小信号增益: 符号: S21; 典型值: 19; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±1; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 36; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-27000-31000-PS43T

27000–31000 MHz 功率放大器裸片

PSAT: 43 dBm (典型值); PAE: 28 % (典型值); 小信号增益: 23 dB (典型值). 裸片尺寸: 3.26 × 4.8 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 27000; 最大值: 31000; 数值: 27000–31000; 单位: MHz

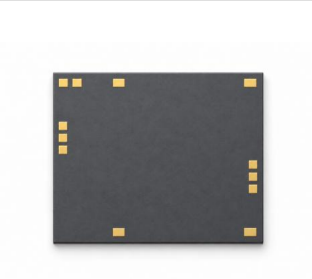
小信号增益: 符号: S21; 典型值: 23; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±0.5; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 43; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-50000-63000-PS37T

50000–63000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 37 dBm (典型值); PAE: 20 % (典型值); 小信号增益: 18 dB (典型值). 裸片尺寸: 2.9 × 2.4 × 0.05 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 50000; 最大值: 63000; 数值: 50000–63000; 单位: MHz

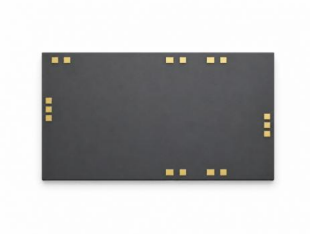
小信号增益: 符号: S21; 典型值: 18; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±1.5; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 37; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.77 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-92000-96000-PS34T

92000–96000 MHz MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 34 dBm (典型值); PAE: 10 % (典型值); 小信号增益: 19 dB (典型值). 裸片尺寸: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 92000; 最大值: 96000; 数值: 92000–96000; 单位: MHz

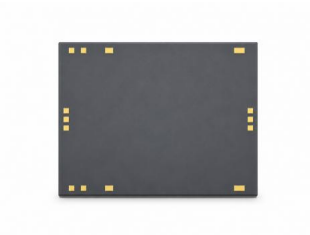
小信号增益: 符号: S21; 典型值: 19; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±1; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 34; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-18000-26500-PS41T

18000–26500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 41 dBm (典型值); PAE: 26 % (典型值); 功率增益: 19 dB (典型值). 裸片尺寸: 4.1 × 3.2 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 18000; 最大值: 26500; 数值: 18000–26500; 单位: MHz

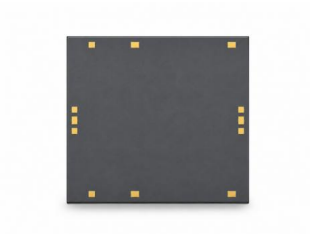
小信号增益: 符号: S21; 典型值: 25; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±0.4; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 41; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-27000-31000-PS42T

27000–31000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 42 dBm (典型值); PAE: 30 % (典型值); 小信号增益: 23 dB (典型值). 裸片尺寸: 3.26 × 3 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 27000; 最大值: 31000; 数值: 27000–31000; 单位: MHz

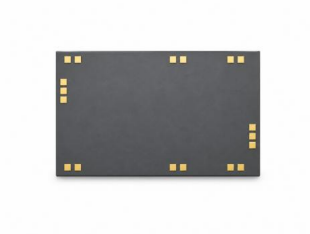
小信号增益: 符号: S21; 典型值: 23; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.5; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 42; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.5 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-15000-43000-PS30T

15000–43000 MHz 功率放大器裸片

PSAT: 30 dBm (典型值); PAE: 18 % (典型值); 小信号增益: 18 dB (最小值) / 20 dB (典型值) / 22 dB (最大值). 裸片尺寸: 3.94 × 2.48 × 0.07 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 15000; 最大值: 43000; 数值: 15000–43000; 单位: MHz

小信号增益: 符号: S21; 最小值: 18; 典型值: 20; 最大值: 22; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±2; 单位: dB

1 dB 压缩点输出功率: 典型值: 29.5; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 0.9 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-92000-96000-PS26p5T

92000–96000 MHz 功率放大器裸片

PSAT: 26.5 dBm (典型值); PAE: 12 % (典型值) / 13 % (最大值); 小信号增益: 18 dB (典型值). 裸片尺寸: 3.25 × 1.15 × 0.05 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 92000; 最大值: 96000; 数值: 92000–96000; 单位: MHz

小信号增益: 符号: S21; 典型值: 18; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±0.5; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 26.5; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.11 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG21T

15000–17000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 45 dBm (典型值); 功率增益: 21 dB (典型值); PAE: 37 % (典型值). 裸片尺寸: 3.45 × 3.95 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 15000; 最大值: 17000; 数值: 15000–17000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 21; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-12700-14500-PS47T

12700–14500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 46.8 dBm (最小值) / 47 dBm (典型值); 功率增益: 18.8 dB (最小值) / 19 dB (典型值); PAE: 37 % (典型值). 裸片尺寸: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 12700; 最大值: 14500; 数值: 12700–14500; 单位: MHz

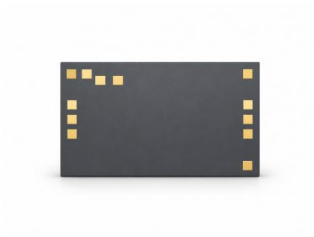
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 46.8; 典型值: 47; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 18.8; 典型值: 19; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.96 V; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-15000-18000-PS38T

15000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 38 dBm (典型值); 功率增益: 20 dB (典型值); PAE: 40 % (典型值). 裸片尺寸: 2.3 × 1.35 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 15000; 最大值: 18000; 数值: 15000–18000; 单位: MHz

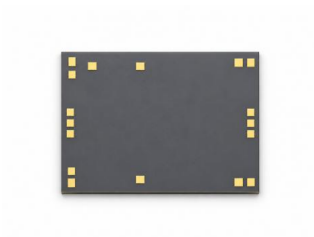
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 38; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.35; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-13000-15000-PS42T

13000–15000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 42 dBm (典型值); 功率增益: 21 dB (典型值); PAE: 35 % (最小值) / 37 % (典型值). 裸片尺寸: 2.8 × 2 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 13000; 最大值: 15000; 数值: 13000–15000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 42; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 21; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.35; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-12000-15000-PS47p5T

12000–15000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 47 dBm (最小值) / 47.5 dBm (典型值); 功率增益: 22 dB (最小值) / 22.5 dB (典型值); PAE: 30 % (最小值) / 34 % (典型值). 裸片尺寸: 4.1 × 5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 12000; 最大值: 15000; 数值: 12000–15000; 单位: MHz

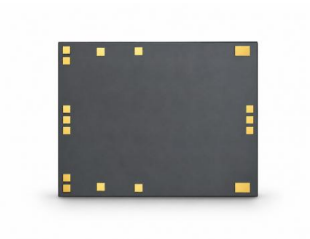
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 47; 典型值: 47.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 22; 典型值: 22.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG24T

15000–17000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 45 dBm (典型值); 功率增益: 24 dB (典型值); PAE: 43 % (典型值). 裸片尺寸: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 15000; 最大值: 17000; 数值: 15000–17000; 单位: MHz

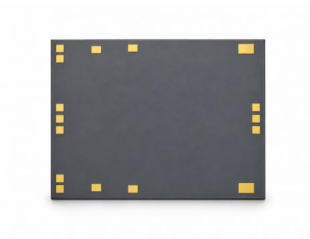
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 24; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-14000-18000-PS45T

14000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 45 dBm (典型值); 功率增益: 24 dB (典型值); PAE: 41 % (典型值). 裸片尺寸: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 24; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-15000-18500-PS48T

15000–18500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 48 dBm (典型值); 功率增益: 22 dB (典型值); PAE: 38 % (典型值). 裸片尺寸: 3.34 × 4.95 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 15000; 最大值: 18500; 数值: 15000–18500; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 48; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 22; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-13750-15350-PS48T

13750–15350 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 47 dBm (最小值) / 48 dBm (典型值); 功率增益: 19 dB (最小值) / 20 dB (典型值); PAE: 35 % (典型值). 裸片尺寸: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 13750; 最大值: 15350; 数值: 13750–15350; 单位: MHz

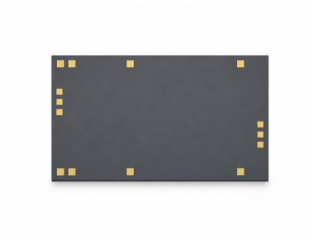
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 47; 典型值: 48; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 19; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-34000-64000-PS30T

34000–64000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 30 dBm (典型值); PAE: 17 % (典型值); 功率增益: 17 dB (典型值). 裸片尺寸: 3.9 × 2.3 × 0.07 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 34000; 最大值: 64000; 数值: 34000–64000; 单位: MHz

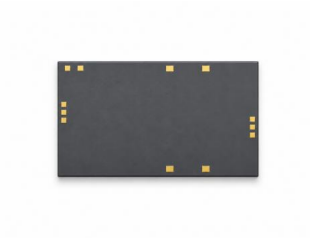
小信号增益: 符号: S21; 典型值: 19; 单位: dB

1 dB 压缩点输出功率: 典型值: 27; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 30; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +4 V; Id = 0.81 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-92000-96000-PS34p5T

92000–96000 MHz MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 34.5 dBm (典型值); PAE: 14 % (典型值); 小信号增益: 22 dB (典型值). 裸片尺寸: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 92000; 最大值: 96000; 数值: 92000–96000; 单位: MHz

小信号增益: 符号: S21; 典型值: 22; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔS21; 典型值: ±1; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 34.5; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +15 V; Id = 0.28 A

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T

8000–12000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片

噪声系数: 0.7 dB (典型值) / 0.75 dB (最大值); 小信号增益: 26.5 dB (最小值) / 28 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率: 10 dBm (典型值). 裸片尺寸: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 典型值: 10; 单位: dBm

小信号增益: 最小值: 26.5; 典型值: 28; 单位: dB

小信号增益平坦度: 典型值: ±1.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T-M

8000–12000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片

噪声系数: 0.7 dB (典型值) / 0.75 dB (最大值); 小信号增益: 26.5 dB (最小值) / 28 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率: 10 dBm (典型值). 裸片尺寸: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 典型值: 10; 单位: dBm

小信号增益: 最小值: 26.5; 典型值: 28; 单位: dB

小信号增益平坦度: 典型值: ±1.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T

14000–15000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片

噪声系数: 1.1 dB (典型值); 小信号增益: 32 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率: 5 dBm (典型值). 裸片尺寸: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 14000; 最大值: 15000; 数值: 14000–15000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 典型值: 5; 单位: dBm

小信号增益: 典型值: 32; 单位: dB

小信号增益平坦度: 典型值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T-M

14000–15000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片

噪声系数: 1.1 dB (典型值); 小信号增益: 32 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率: 5 dBm (典型值). 裸片尺寸: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 14000; 最大值: 15000; 数值: 14000–15000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 典型值: 5; 单位: dBm

小信号增益: 典型值: 32; 单位: dB

小信号增益平坦度: 典型值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T

800–4000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片

噪声系数: 0.4 dB (典型值); 小信号增益: 32 dB (典型值) (Vd = +5 V); 输出1 dB压缩点功率: 15 dBm (典型值) (Vd = +5 V). 裸片尺寸: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 800; 最大值: 4000; 数值: 800–4000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 典型值: 15; 数值: Vd = +5 V; 单位: dBm

小信号增益: 典型值: 32; 数值: Vd = +5 V; 单位: dB

小信号增益平坦度: 典型值: ±1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T-M

800–4000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片

噪声系数: 0.4 dB (典型值); 小信号增益: 32 dB (典型值) (Vd = +5 V); 输出1 dB压缩点功率: 15 dBm (典型值) (Vd = +5 V). 裸片尺寸: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 800; 最大值: 4000; 数值: 800–4000; 单位: MHz

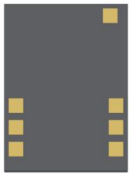
输出1 dB压缩点功率: 典型值: 15; 数值: Vd = +5 V; 单位: dBm

小信号增益: 典型值: 32; 数值: Vd = +5 V; 单位: dB

小信号增益平坦度: 典型值: ±1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-30-600-NF0p6T

30–600 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片

噪声系数: 0.6 dB (典型值); 小信号增益: 32.3 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.85 × 1.15 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 30; 最大值: 600; 数值: 30–600; 单位: MHz

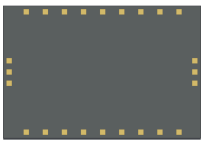
小信号增益: 典型值: 32.3; 单位: dB

小信号增益平坦度: 典型值: ±0.3; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C; Vd = +4 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-75000-110000-NF3p3MAX

75000–110000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片

噪声系数: 2.8 dB (典型值) (f = 90000 MHz); 噪声系数: 3.3 dB (最大值); 小信号增益: 25 dB (典型值) (f = 75000–90000 MHz); 小信号增益: 22 dB (典型值) (f = 90000–110000 MHz). 裸片尺寸: 2 × 3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 75000; 最大值: 110000; 数值: 75000–110000; 单位: MHz

小信号增益: 典型值: 25; 单位: dB; 备注: f = 75000–90000 MHz

小信号增益: 典型值: 22; 单位: dB; 备注: f = 90000–110000 MHz

输入回波损耗: 典型值: 6; 单位: dB

TA = +25 °C; VD1–VD4 = +1 V; VG1–VG4 = 0 V; IDtotal = 0.033 A

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-17000-22000-NF1p3T

17000–22000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片

噪声系数: 1.3 dB (典型值); 小信号增益: 26 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率: 4 dBm (典型值). 裸片尺寸: 1.5 × 0.75 × 0.07 mm.

工作频率: 最小值: 17000; 最大值: 22000; 数值: 17000–22000; 单位: MHz

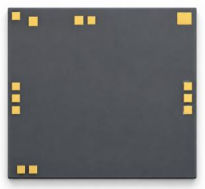
小信号增益: 典型值: 26; 单位: dB

小信号增益平坦度: 典型值: ±0.5; 单位: dB

噪声系数: 典型值: 1.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2700-3900-PS31T

2700–3900 MHz GaAs MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 30.5 dBm (最小值) / 31 dBm (典型值); 功率增益: 35.5 dB (最小值) / 36 dB (典型值); PAE: 45 % (最小值) / 48 % (典型值). 裸片平面尺寸: 2.5 × 2.262 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3900; 数值: 2700–3900; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 30.5; 典型值: 31; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 35.5; 典型值: 36; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.8 V; Pin = -5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2700-3900-PS34p5T

2700–3900 MHz GaAs MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 34 dBm (最小值) / 34.5 dBm (典型值); 功率增益: 29 dB (最小值) / 29.5 dB (典型值); PAE: 47 % (最小值) / 49 % (典型值). 裸片平面尺寸: 2.2 × 3.092 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3900; 数值: 2700–3900; 单位: MHz

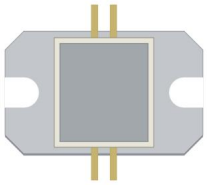
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 34; 典型值: 34.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 29; 典型值: 29.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.7 V; Pin = 5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-PA-200-2200-PS41T

200–2200 MHz 金属陶瓷封装GaN MMIC功率放大器

饱和输出功率: 39.5 dBm (最小值) / 41 dBm (典型值); 功率增益: 23.5 dB (最小值) / 25 dB (典型值); 功率附加效率: 40 % (最小值) / 50 % (典型值).

工作频率: 最小值: 200; 最大值: 2200; 数值: 200–2200; 单位: MHz

饱和输出功率: 最小值: 39.5; 典型值: 41; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 23.5; 典型值: 25; 单位: dB

功率增益平坦度: 最大值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = +16 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG28T

8000–12000 MHz QFN封装低噪声放大器芯片

噪声系数: 0.9 dB (典型值); 小信号增益: 28 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率: 10 dBm (典型值). 封装尺寸: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 典型值: 10; 单位: dBm

小信号增益: 典型值: 28; 单位: dB

噪声系数: 典型值: 0.9; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG28T-M

8000–12000 MHz QFN封装低噪声放大器芯片

噪声系数: 0.9 dB (典型值); 小信号增益: 28 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率: 10 dBm (典型值). 封装尺寸: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

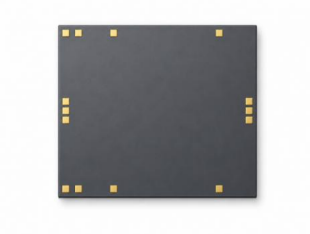
输出1 dB压缩点功率: 典型值: 10; 单位: dBm

小信号增益: 典型值: 28; 单位: dB

噪声系数: 典型值: 0.9; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-PA-6000-18000-PS42T

6000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

6000–18000 MHz; 饱和输出功率: 42 dBm (典型值); 功率增益: 17 dB (典型值); 功率附加效率: 20 % (典型值); 裸片尺寸: 3.9 × 3.4 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 41.2; 典型值: 42; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 16.2; 典型值: 17; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS29T

8000–12000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–12000 MHz; 饱和输出功率: 29 dBm (典型值); 功率增益: 14 dB (典型值); 功率附加效率: 15 % (典型值); 裸片尺寸: 1.95 × 1.35 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 单位: MHz

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 13; 典型值: 14; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.5; 单位: dB

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 29; 单位: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4000-8000-PS43p5T

4000–8000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

4000–8000 MHz; PSAT 43.5 dBm (典型值); 功率增益 20.5 dB (典型值); PAE 40% (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 8000; 单位: MHz

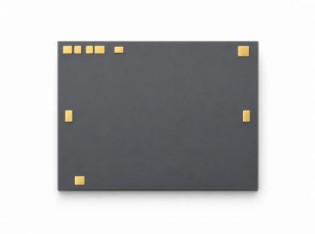
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 43; 典型值: 43.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 20; 典型值: 20.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-6000-PS40p5T

2000–6000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2000–6000 MHz; 饱和输出功率: 40.5 dBm (典型值); 功率增益: 22.5 dB (典型值); 功率附加效率: 38 % (典型值); 裸片尺寸: 2.8 × 2.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 单位: MHz

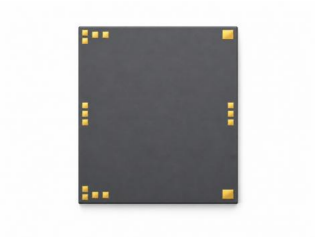
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 39.5; 典型值: 40.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 21.5; 典型值: 22.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.8; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-6000-PS45p8T

2000–6000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2000–6000 MHz; 饱和输出功率: 45.8 dBm (典型值); 功率增益: 18.8 dB (典型值); 功率附加效率: 42 % (典型值); 裸片尺寸: 3.17 × 3.58 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 单位: MHz

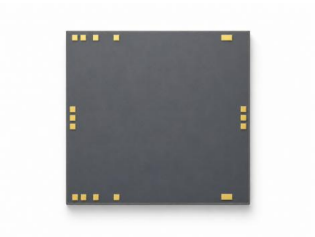
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 44.8; 典型值: 45.8; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 17.8; 典型值: 18.8; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1.8; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 27 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4000-10000-PS45T

4000–10000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

4000–10000 MHz; 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 17 dB (典型值); 功率附加效率: 30 % (典型值); 裸片尺寸: 4.1 × 3.9 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 10000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 43.8; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 15.8; 典型值: 17; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.8; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2500-6200-PS45p5T

2500–6200 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2500–6200 MHz; PSAT 45.5 dBm (典型值); 功率增益 17.5 dB (典型值); PAE 40% (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2500; 最大值: 6200; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 45; 典型值: 45.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 17; 典型值: 17.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8500-10500-PS47p8T

8500–10500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8500–10500 MHz; 饱和输出功率: 47.8 dBm (典型值); 功率增益: 21.8 dB (典型值); 功率附加效率: 47 % (典型值); 裸片尺寸: 4 × 5.1 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8500; 最大值: 10500; 单位: MHz

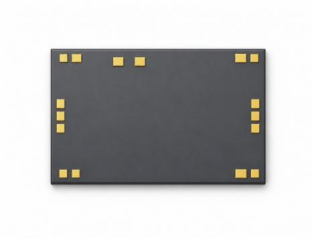
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 47; 典型值: 47.8; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 21; 典型值: 21.8; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS42T-D

8000–12000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–12000 MHz; 饱和输出功率: 42 dBm (典型值); 功率增益: 22 dB (典型值); 功率附加效率: 43 % (典型值); 裸片尺寸: 3.04 × 1.91 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 41.2; 典型值: 42; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 21.2; 典型值: 22; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-18000-PS40T

2000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2000–18000 MHz; PSAT 40 dBm (典型值); 功率增益 12 dB (典型值); PAE 20% (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 18000; 单位: MHz

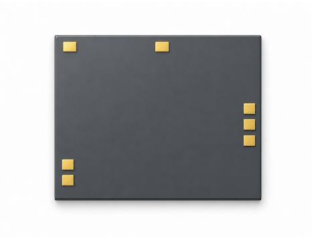
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 40; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 12; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-6000-18000-PS33p5T

6000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

6000–18000 MHz; 饱和输出功率: 33.5 dBm (典型值); 功率增益: 12 dB (典型值); 功率附加效率: 20 % (典型值); 裸片尺寸: 2.1 × 1.7 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 单位: MHz

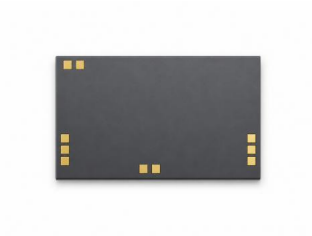
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 33; 典型值: 33.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 11; 典型值: 12; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-18000-PS35T

2000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2000–18000 MHz; PSAT 35 dBm (典型值); 功率增益 7 dB (典型值); PAE 20% (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 18000; 单位: MHz

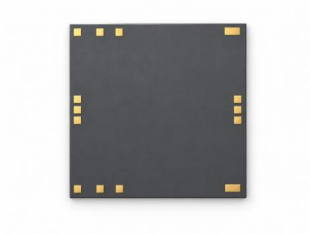
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 35; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 7; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.5 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-9200-10400-PS46p2T

9200–10400 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

9200–10400 MHz; 饱和输出功率: 46.2 dBm (典型值); 功率增益: 24.2 dB (典型值); 功率附加效率: 50 % (典型值); 裸片尺寸: 3 × 3.03 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 9200; 最大值: 10400; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 46; 典型值: 46.2; 最大值: 46.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 24; 典型值: 24.2; 最大值: 24.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-7500-10500-PS49T

7500–10500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

7500–10500 MHz; 饱和输出功率: 49 dBm (典型值); 功率增益: 25 dB (典型值); 功率附加效率: 40 % (典型值); 裸片尺寸: 3.7 × 6 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 7500; 最大值: 10500; 单位: MHz

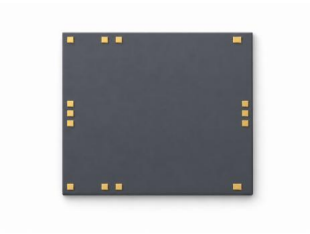
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 48.6; 典型值: 49; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 24.6; 典型值: 25; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-7000-13000-PS45T

7000–13000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

7000–13000 MHz; 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 22 dB (典型值); 功率附加效率: 40 % (典型值); 裸片尺寸: 3.5 × 3.2 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 7000; 最大值: 13000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 44; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 21; 典型值: 22; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-6000-18000-PS45T

6000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

6000–18000 MHz; 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 20 dB (典型值); 功率附加效率: 23 % (典型值); 裸片尺寸: 4.52 × 5.82 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 44.5; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 19.5; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-5000-6000-PS49p5T

5000–6000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

5000–6000 MHz; 饱和输出功率: 49.5 dBm (典型值); 功率增益: 26.5 dB (典型值); 功率附加效率: 50 % (典型值); 裸片尺寸: 3.5 × 5.8 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 6000; 单位: MHz

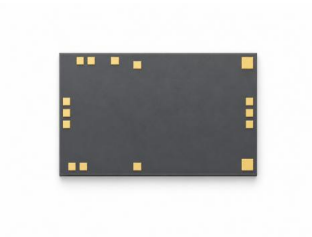
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 49; 典型值: 49.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 26; 典型值: 26.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.2; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-6000-18000-PS40T

6000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

6000–18000 MHz; 饱和输出功率: 40 dBm (典型值); 功率增益: 19 dB (典型值); 功率附加效率: 23 % (典型值); 裸片尺寸: 3 × 1.8 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 单位: MHz

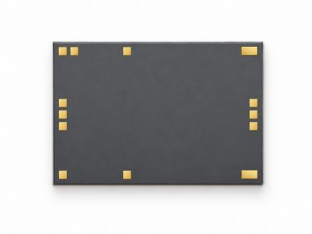
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 39; 典型值: 40; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 18; 典型值: 19; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.8; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-10000-18000-PS41T

10000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

10000–18000 MHz; 饱和输出功率: 41 dBm (典型值); 功率增益: 19 dB (典型值); 功率附加效率: 30 % (典型值); 裸片尺寸: 3.2 × 2.25 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 10000; 最大值: 18000; 单位: MHz

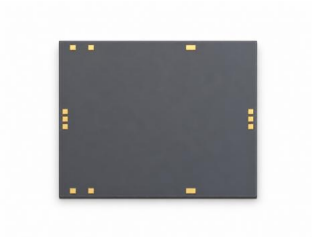
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 40.9; 典型值: 41; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 18.9; 典型值: 19; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-950-1250-PS47p5T

950–1250 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

950–1250 MHz; 饱和输出功率: 47.5 dBm (典型值); 功率增益: 22.5 dB (典型值); 功率附加效率: 60 % (典型值); 裸片尺寸: 4.35 × 3.43 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 950; 最大值: 1250; 单位: MHz

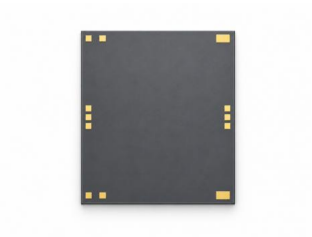
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 47; 典型值: 47.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 22; 典型值: 22.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-5000-6000-PS47p5T

5000–6000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

5000–6000 MHz; 饱和输出功率: 47.5 dBm (典型值); 功率增益: 24.5 dB (典型值); 功率附加效率: 53 % (典型值); 裸片尺寸: 3.1 × 3.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 6000; 单位: MHz

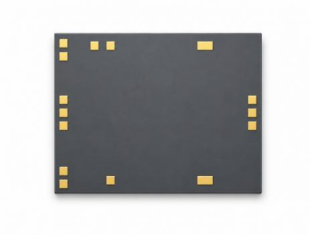
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 47; 典型值: 47.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 24; 典型值: 24.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS43p5T

8000–12000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–12000 MHz; 饱和输出功率: 43.5 dBm (典型值); 功率增益: 22.5 dB (典型值); 功率附加效率: 45 % (典型值); 裸片尺寸: 2.7 × 2.08 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 43; 典型值: 43.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 22; 典型值: 22.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS39T-D

8000–12000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–12000 MHz; 饱和输出功率: 39 dBm (典型值); 功率增益: 18 dB (典型值); 功率附加效率: 43 % (典型值); 裸片尺寸: 2.3 × 1.15 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 38; 典型值: 39; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 17; 典型值: 18; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.7; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8500-10500-PS52T

8500–10500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8500–10500 MHz; 饱和输出功率: 52 dBm (典型值); 功率增益: 24 dB (典型值); 功率附加效率: 45 % (典型值); 裸片尺寸: 3.9 × 6.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8500; 最大值: 10500; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 52; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 24; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +48 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4000-8000-PS47p5T

4000–8000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

4000–8000 MHz; PSAT 47.5 dBm (典型值); 功率增益 17.5 dB (典型值); PAE 40% (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 8000; 单位: MHz

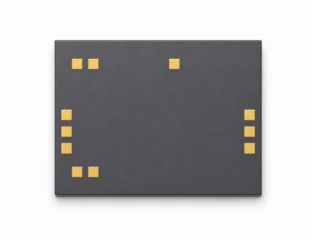
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 47; 典型值: 47.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 17; 典型值: 17.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.8; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4000-8000-PS37T

4000–8000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

4000–8000 MHz; PSAT 37 dBm (典型值); 功率增益 20 dB (典型值); PAE 35% (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 8000; 单位: MHz

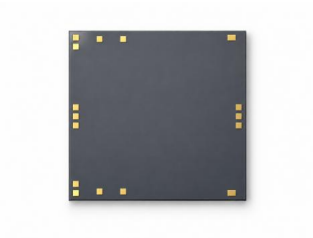
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 36.5; 典型值: 37; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 19.5; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS47T

8000–12000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–12000 MHz; 饱和输出功率: 47 dBm (典型值); 功率增益: 25 dB (典型值); 功率附加效率: 45 % (典型值); 裸片尺寸: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. RF 测试条件: Vd = +28 V; Vg = -2.6 V.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 单位: MHz

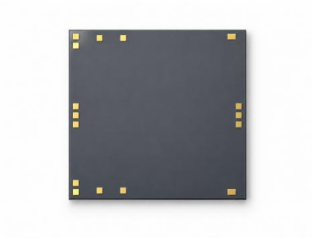
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 46.5; 典型值: 47; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 24.5; 典型值: 25; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS47T-B

8000–12000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–12000 MHz; 饱和输出功率: 47 dBm (典型值); 功率增益: 25 dB (典型值); 功率附加效率: 45 % (典型值); 裸片尺寸: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. RF 测试条件: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 单位: MHz

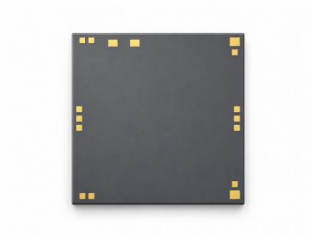
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 46.5; 典型值: 47; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 24.5; 典型值: 25; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-3600-5000-PS44p5T

3600–5000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

3600–5000 MHz; PSAT 44.5 dBm (典型值); 功率增益 23.5 dB (典型值); PAE 43% (典型值); τ = 100 µs; D = 10%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 3600; 最大值: 5000; 单位: MHz

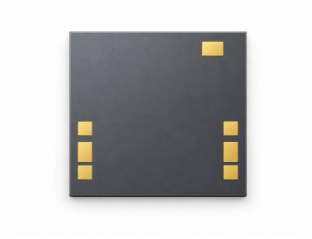
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 44; 典型值: 44.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 23; 典型值: 23.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-5000-13000-PS25T

5000–13000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

5000–13000 MHz; 饱和输出功率: 25 dBm (典型值); 功率增益: 10 dB (典型值); 裸片尺寸: 1.3 × 1.25 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 13000; 单位: MHz

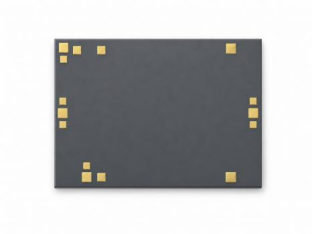
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 25; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 10; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 15 dBm; °CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-5000-13000-PS42T

5000–13000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

5000–13000 MHz; 饱和输出功率: 42 dBm (典型值); 功率增益: 20 dB (典型值); 功率附加效率: 35 % (典型值); 裸片尺寸: 3.1 × 2.26 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 13000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 42; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4200-7000-PS42T

4200–7000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

4200–7000 MHz; PSAT 42 dBm (典型值); 功率增益 22 dB (典型值); PAE 45% (典型值); τ = 100 µs; D = 10%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 4200; 最大值: 7000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 41.8; 典型值: 42; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 21.8; 典型值: 22; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-6000-PS45p5T

2000–6000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2000–6000 MHz; PSAT 45.5 dBm (典型值); 功率增益 20.5 dB (典型值); PAE 35% (典型值); CW; Vd = +24 V.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 单位: MHz

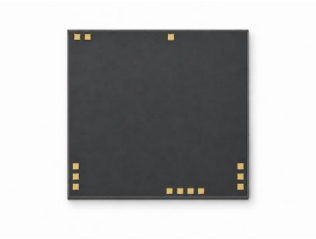
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 45; 典型值: 45.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 20; 典型值: 20.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +24 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-200-2200-PS41p5T

200–2200 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

200–2200 MHz GaN-on-SiC 功放裸片，饱和输出功率典型值 41.5 dBm，功率增益典型值 25.5 dB，尺寸 3.00 × 3.00 × 0.10 mm。

工作频率: 符号: f; 最小值: 200; 最大值: 2200; 单位: MHz

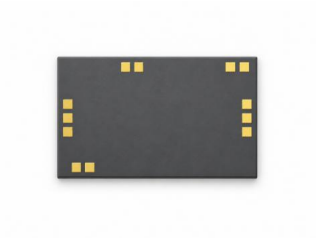
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 41.0; 典型值: 41.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 25.0; 典型值: 25.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1.0; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = −2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-3400-5600-PS40T

3400–5600 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

3400–5600 MHz; PSAT 40 dBm (典型值); 功率增益 17 dB (典型值); PAE 46% (典型值); CW.

工作频率: 符号: f; 最小值: 3400; 最大值: 5600; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 39; 典型值: 40; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 16; 典型值: 17; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-5800-6800-PS47T

5800–6800 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

5800–6800 MHz; 饱和输出功率: 47 dBm (典型值); 功率增益: 21 dB (典型值); 功率附加效率: 46 % (典型值); 裸片尺寸: 3.5 × 5.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 5800; 最大值: 6800; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 47; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 21; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-D

2700–3500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (典型值); 功率增益 25.5 dB (典型值); PAE 58% (典型值); CW.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3500; 单位: MHz

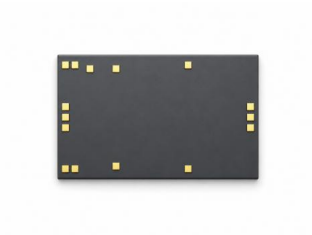
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 45; 典型值: 45.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 25; 典型值: 25.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-6700-7400-PS41T

6700–7400 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

6700–7400 MHz; 饱和输出功率: 41 dBm (典型值); 功率增益: 22 dB (典型值); 功率附加效率: 55 % (典型值); 裸片尺寸: 3.2 × 2 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6700; 最大值: 7400; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 41; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 22; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-6000-18000-PS27T

6000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

6000–18000 MHz; 饱和输出功率: 27 dBm (典型值); 功率增益: 9 dB (典型值); 裸片尺寸: 1.5 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 单位: MHz

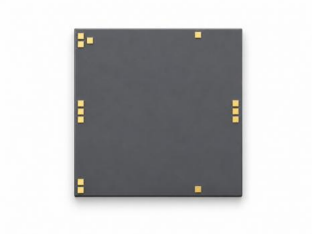
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 26; 典型值: 27; 最大值: 29; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 8; 典型值: 9; 最大值: 11; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 18 dBm; °CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-8000-PS42T

2000–8000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2000–8000 MHz; PSAT 42 dBm (典型值); 功率增益 15 dB (典型值); PAE 30% (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 8000; 单位: MHz

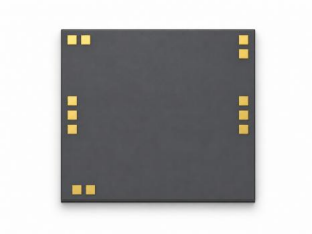
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 41; 典型值: 42; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 14; 典型值: 15; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2500-3700-PS41p5T

2500–3700 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2500–3700 MHz; PSAT 41.5 dBm (典型值); 功率增益 22.5 dB (典型值); PAE 50% (典型值); τ = 100 µs; D = 10%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2500; 最大值: 3700; 单位: MHz

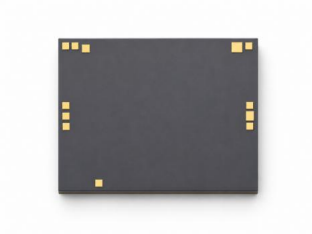
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 41; 典型值: 41.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 22; 典型值: 22.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2600-3300-PS45p5T

2600–3300 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2600–3300 MHz; PSAT 45.5 dBm (典型值); 功率增益 25.5 dB (典型值); PAE 60% (典型值); τ = 100 µs; D = 10%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2600; 最大值: 3300; 单位: MHz

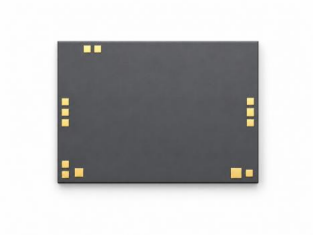
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 45; 典型值: 45.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 25; 典型值: 25.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2400-3800-PS46p5T

2400–3800 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2400–3800 MHz; PSAT 46.5 dBm (典型值); 功率增益 27.5 dB (典型值); PAE 56% (典型值); τ = 100 µs; D = 10%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2400; 最大值: 3800; 单位: MHz

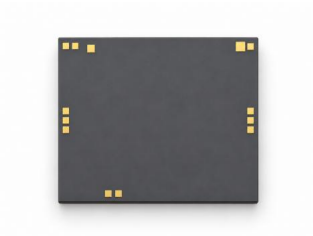
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 46; 典型值: 46.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 27; 典型值: 27.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2500-4000-PS47T

2500–4000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2500–4000 MHz; PSAT 47 dBm (典型值); 功率增益 26 dB (典型值); PAE 52% (典型值); τ = 100 µs; D = 10%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2500; 最大值: 4000; 单位: MHz

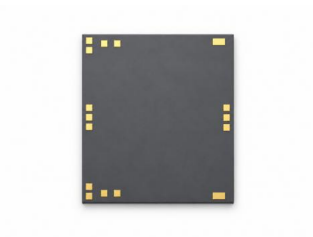
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 46.2; 典型值: 47; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 25.2; 典型值: 26; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-9400-PS45T

8000–9400 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–9400 MHz; 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 31 dB (典型值); 功率附加效率: 52 % (典型值); 裸片尺寸: 3 × 3.2 × 0.1 mm. RF 测试条件: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 9400; 单位: MHz

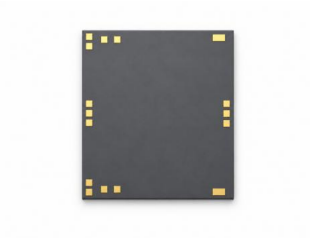
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 31; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-9400-PS45T-A

8000–9400 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–9400 MHz; 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 31 dB (典型值); 功率附加效率: 52 % (典型值); 裸片尺寸: 3 × 3.2 × 0.1 mm. RF 测试条件: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 9400; 单位: MHz

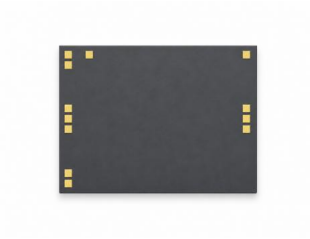
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 31; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-1200-1600-PS43p5T

1200–1600 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

1200–1600 MHz; 饱和输出功率: 43.5 dBm (典型值); 功率增益: 17 dB (典型值); 功率附加效率: 60 % (典型值); 裸片尺寸: 2.7 × 2 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 1200; 最大值: 1600; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 43.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 17; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-18000-PS46p5T

8000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–18000 MHz; 饱和输出功率: 46.5 dBm (典型值); 功率增益: 18 dB (典型值); 功率附加效率: 28 % (典型值); 裸片尺寸: 4 × 5.6 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 18000; 单位: MHz

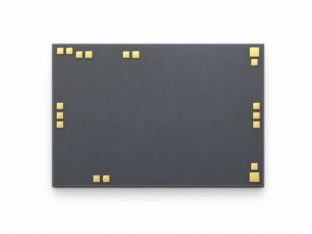
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 46; 典型值: 46.5; 最大值: 47.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 18; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4400-6500-PS44T

4400–6500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

4400–6500 MHz; 饱和输出功率: 44 dBm (典型值); 功率增益: 27 dB (典型值); 功率附加效率: 47 % (典型值); 裸片尺寸: 3.51 × 2.44 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 4400; 最大值: 6500; 单位: MHz

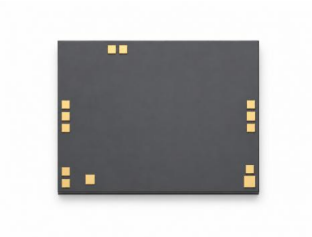
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 43.5; 典型值: 44; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 26.5; 典型值: 27; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2700-3500-PS43p5T

2700–3500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2700–3500 MHz; PSAT 43.5 dBm (典型值); 功率增益 26.5 dB (典型值); PAE 61% (典型值); τ = 100 µs; D = 10%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3500; 单位: MHz

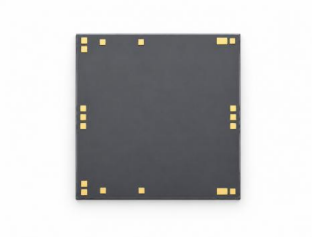
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 43; 典型值: 43.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 26; 典型值: 26.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 0.6; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-10800-13000-PS45T

10800–13000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

10800–13000 MHz; 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 21 dB (典型值); 功率附加效率: 38 % (典型值); 裸片尺寸: 3.4 × 3.52 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 10800; 最大值: 13000; 单位: MHz

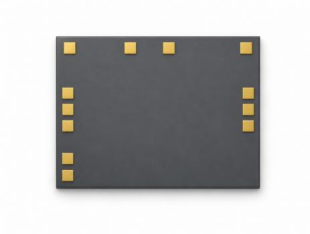
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 21; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-9000-11000-PS37T

9000–11000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

9000–11000 MHz; 饱和输出功率: 37 dBm (典型值); 功率增益: 22 dB (典型值); 功率附加效率: 38 % (典型值); 裸片尺寸: 2.04 × 1.54 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 9000; 最大值: 11000; 单位: MHz

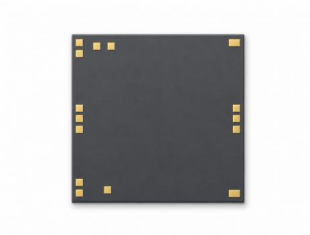
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 37; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 22; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.2; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-8400-PS45T

8000–8400 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–8400 MHz; 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 23 dB (典型值); 功率附加效率: 55 % (典型值); 裸片尺寸: 2.9 × 2.8 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 8400; 单位: MHz

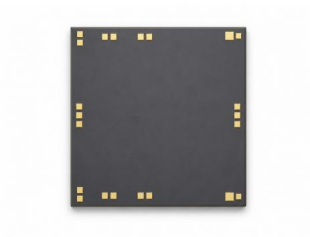
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 23; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-3700-5000-PS45p2T

3700–5000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

3700–5000 MHz; PSAT 45.2 dBm (典型值); 功率增益 27 dB (典型值); PAE 48% (典型值); τ = 100 µs; D = 10%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 3700; 最大值: 5000; 单位: MHz

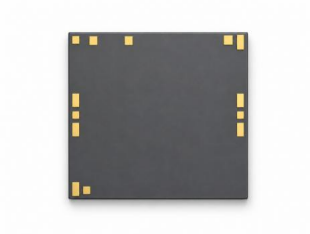
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 45; 典型值: 45.2; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 26.8; 典型值: 27; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 18 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-6000-PS43T-D

2000–6000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2000–6000 MHz; 饱和输出功率: 43 dBm (典型值); 功率增益: 26.5 dB (典型值); 功率附加效率: 50 % (典型值); 裸片尺寸: 3.1 × 2.9 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 单位: MHz

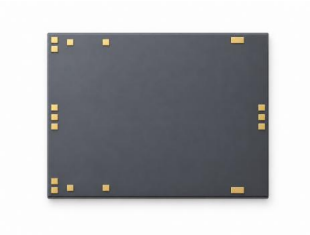
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 42.5; 典型值: 43; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 25.5; 典型值: 26.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 0.6; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-6000-18000-PS44T

6000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

6000–18000 MHz; 饱和输出功率: 44 dBm (典型值); 功率增益: 20 dB (典型值); 功率附加效率: 30 % (典型值); 裸片尺寸: 4 × 3.3 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 单位: MHz

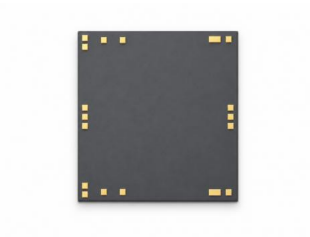
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 44; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-18000-PS44T

8000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–18000 MHz; 饱和输出功率: 44 dBm (典型值); 功率增益: 19 dB (典型值); 功率附加效率: 30 % (典型值); 裸片尺寸: 3.5 × 4 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 18000; 单位: MHz

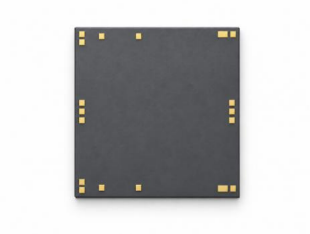
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 44; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 19; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-10000-13000-PS45T

10000–13000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

10000–13000 MHz; 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 20 dB (典型值); 功率附加效率: 40 % (典型值); 裸片尺寸: 3.3 × 3.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 10000; 最大值: 13000; 单位: MHz

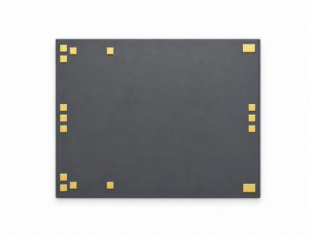
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-18000-PS43p5T

8000–18000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

8000–18000 MHz; 饱和输出功率: 43.5 dBm (典型值); 功率增益: 19.5 dB (典型值); 功率附加效率: 30 % (典型值); 裸片尺寸: 3.2 × 2.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 18000; 单位: MHz

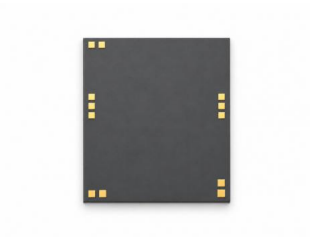
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 43.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 19.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-2800-PS41T

2000–2800 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2000–2800 MHz; 饱和输出功率: 41 dBm (典型值); 功率增益: 24 dB (典型值); 功率附加效率: 56 % (典型值); 裸片尺寸: 2.4 × 2.7 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 2800; 单位: MHz

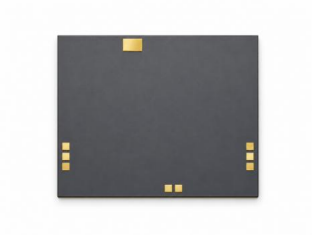
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 40.7; 典型值: 41; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 23.7; 典型值: 24; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: 1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-300-6000-PS40p8T

300–6000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

300–6000 MHz; 饱和输出功率: 40.8 dBm (典型值); 功率增益: 12.8 dB (典型值); 功率附加效率: 40 % (典型值); 裸片尺寸: 2.95 × 2.4 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 300; 最大值: 6000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 40; 典型值: 40.8; 最大值: 41.6; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 12; 典型值: 12.8; 最大值: 13.6; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.8; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-18500-PS43T

2000–18500 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2000–18500 MHz; PSAT 43 dBm (典型值); 功率增益 13 dB (典型值); PAE 20% (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 18500; 单位: MHz

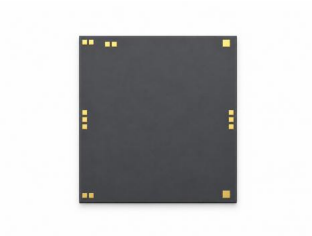
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 43; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 13; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-1950-4050-PS46p5T

1950–4050 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

1950–4050 MHz; 饱和输出功率: 46.5 dBm (典型值); 功率增益: 24.5 dB (典型值); 功率附加效率: 52 % (典型值); 裸片尺寸: 3.56 × 3.78 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 1950; 最大值: 4050; 单位: MHz

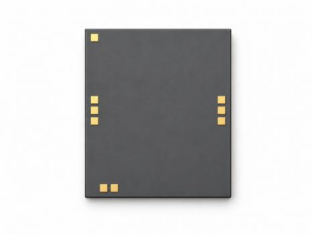
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 46; 典型值: 46.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 24; 典型值: 24.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 22 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-300-6000-PS30T

300–6000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

300–6000 MHz; 饱和输出功率: 30 dBm (典型值); 功率增益: 15 dB (典型值); 功率附加效率: 15 % (典型值); 裸片尺寸: 2.15 × 2.46 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 300; 最大值: 6000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 28; 典型值: 30; 最大值: 32.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 13; 典型值: 15; 最大值: 17.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±2.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2700-3900-PS48T

2700–3900 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

2700–3900 MHz; PSAT 48 dBm (典型值); 功率增益 24 dB (典型值); PAE 56% (典型值); τ = 100 µs; D = 10%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3900; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 47.6; 典型值: 48; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 23.6; 典型值: 24; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.6; 单位: dB

Vd = +28 V; Vg = -2.7 V; Pin = 24 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-10000-13000-PS30p5T

10000–13000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

10000–13000 MHz; 饱和输出功率: 30.5 dBm (典型值); 功率增益: 30 dB (典型值); 功率附加效率: 22 % (典型值); 裸片尺寸: 2.22 × 1.16 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 10000; 最大值: 13000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 30; 典型值: 30.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 30; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-10000-13000-PS48T

10000–13000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

10000–13000 MHz; 饱和输出功率: 48 dBm (典型值); 功率增益: 20 dB (典型值); 功率附加效率: 37 % (典型值); 裸片尺寸: 3.4 × 5.74 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 10000; 最大值: 13000; 单位: MHz

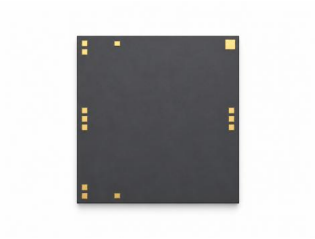
饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 47; 典型值: 48; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 19; 典型值: 20; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.2 A

产品详情　产品规格书



LCI-PA-1200-2400-PS45T

1200–2400 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

1200–2400 MHz; 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 25 dB (典型值); 功率附加效率: 53 % (典型值); 裸片尺寸: 3.1 × 3.2 × 0.08 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 1200; 最大值: 2400; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 44.5; 典型值: 45; 最大值: 45.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 24.5; 典型值: 25; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-6000-12000-PS48T

6000–12000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

6000–12000 MHz; 饱和输出功率: 48 dBm (典型值); 功率增益: 24 dB (典型值); 功率附加效率: 40 % (典型值); 裸片尺寸: 3.85 × 5.82 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 12000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 48; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 24; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-7000-13000-PS48T

7000–13000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

7000–13000 MHz; 饱和输出功率: 48 dBm (典型值); 功率增益: 24 dB (典型值); 功率附加效率: 40 % (典型值); 裸片尺寸: 3.83 × 5.82 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 7000; 最大值: 13000; 单位: MHz

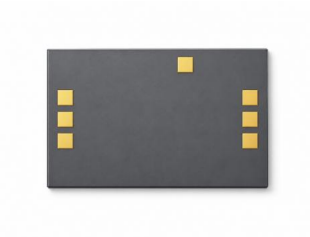
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 48; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 24; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-5000-6000-NF0p6T

5000–6000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.6 dB (典型值)

5000–6000 MHz; NF 0.6 dB (典型值); 小信号增益 28 dB (典型值); P1dB 6 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 6000; 数值: 5000–6000; 单位: MHz

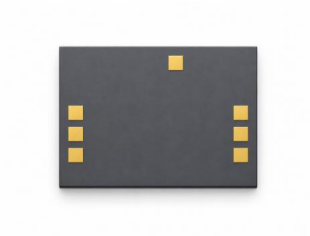
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 6; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 28; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-7000-13000-NF0p9T

7000–13000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.9 dB (典型值)

7000–13000 MHz; NF 0.9 dB (典型值); 小信号增益 22 dB (典型值); P1dB 14 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 7000; 最大值: 13000; 数值: 7000–13000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 14; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 22; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 最大值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-7000-13000-NF1T

7000–13000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 1 dB (典型值)

7000–13000 MHz; NF 1 dB (典型值); 小信号增益 ≥ 28 dB; P1dB 6 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 7000; 最大值: 13000; 数值: 7000–13000; 单位: MHz

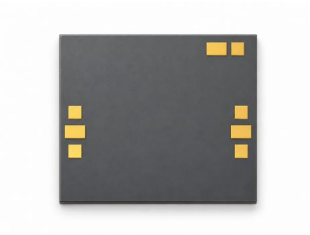
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 6; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 最小值: 28; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±2; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-2000-6000-NF0p8T

2000–6000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.8 dB (典型值)

2000–6000 MHz; NF 0.8 dB (典型值); 小信号增益 ≥ 29 dB; P1dB 10 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

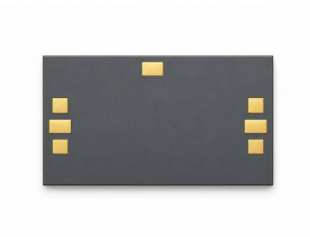
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 10; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 最小值: 29; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±0.2; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-6000-18000-NF1p2T

6000–18000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 1.2 dB (典型值)

6000–18000 MHz; NF 1.2 dB (典型值); 小信号增益 22 dB (典型值); P1dB 8 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

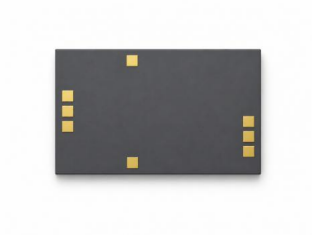
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 8; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 22; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±2; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T

24000–40000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 2.5 dB (典型值)

24000–40000 MHz; NF 2.5 dB (典型值); 小信号增益 23 dB (典型值); P1dB ≥ 11 dBm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 24000; 最大值: 40000; 数值: 24000–40000; 单位: MHz

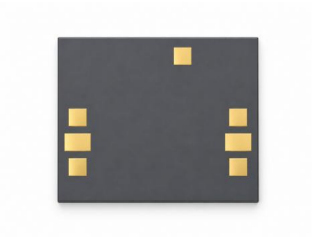
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 最小值: 11; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 23; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG26T

8000–12000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.7 dB (典型值)

8000–12000 MHz; NF 0.7 dB (典型值); 小信号增益 26 dB (典型值); P1dB 8 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

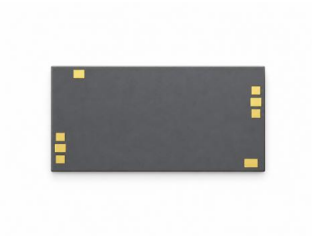
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 最小值: 7; 典型值: 8; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 最小值: 25; 典型值: 26; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 最大值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-2000-20000-NF2T

2000–20000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 2 dB (典型值)

2000–20000 MHz; NF 2 dB (典型值); 小信号增益 17 dB (典型值); P1dB 14 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 20000; 数值: 2000–20000; 单位: MHz

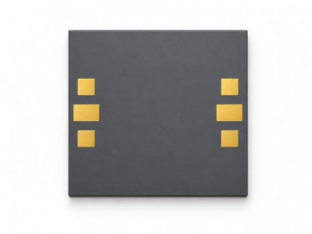
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 14; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 17; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-100-2000-NF1p1T

100–2000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 1.1 dB (典型值)

100–2000 MHz; NF 1.1 dB (典型值); 小信号增益 17.5 dB (典型值); P1dB 19.5 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 2000; 数值: 100–2000; 单位: MHz

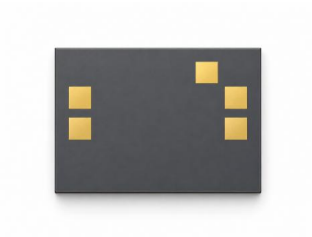
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 19.5; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 17.5; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-800-2000-NF0p45T

800–2000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.45 dB (典型值)

800–2000 MHz; NF 0.45 dB (典型值); 小信号增益 23 dB (典型值); P1dB 20.5 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 800; 最大值: 2000; 数值: 800–2000; 单位: MHz

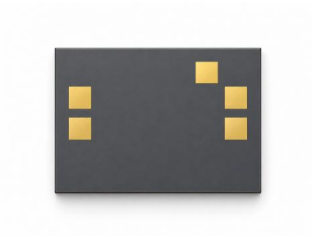
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 20.5; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 22; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 23; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-200-600-NF0p4T

200–600 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.4 dB (典型值)

200–600 MHz; NF 0.4 dB (典型值); 小信号增益 28 dB (典型值); P1dB 21 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 200; 最大值: 600; 数值: 200–600; 单位: MHz

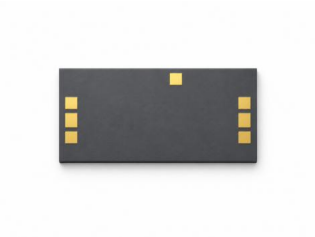
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 21; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 22.5; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 28; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB14T

2000–5000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.45 dB (典型值); P1dB 14 dBm (典型值)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (典型值); 小信号增益 30 dB (典型值); P1dB 14 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 5000; 数值: 2000–5000; 单位: MHz

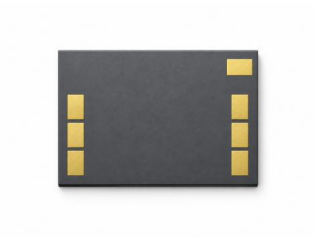
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 14; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 15; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 30; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-7000-9000-NF0p6U

7000–9000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.6 dB

7000–9000 MHz; NF 0.6 dB; 小信号增益 31 dB (典型值); P1dB 15 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 7000; 最大值: 9000; 数值: 7000–9000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 15; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 31; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-6000-20000-NF1p2T

6000–20000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 1.2 dB (典型值)

6000–20000 MHz; NF 1.2 dB (典型值); 小信号增益 26 dB (典型值); P1dB -2 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 20000; 数值: 6000–20000; 单位: MHz

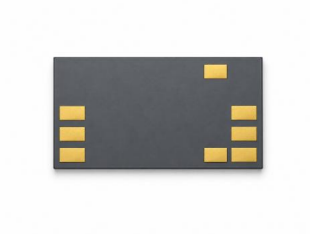
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 最小值: -4; 典型值: -2; 最大值: 0; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 26; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-4000-12000-NF0p6T

4000–12000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.6 dB (典型值)

4000–12000 MHz; NF 0.6 dB (典型值); 小信号增益 34.5 dB (典型值); P1dB 7 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 12000; 数值: 4000–12000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 最小值: 6.5; 典型值: 7; 最大值: 8.5; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 34.5; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±0.2; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB11T

2000–5000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 0.45 dB (典型值); P1dB 11 dBm (典型值)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (典型值); 小信号增益 30 dB (典型值); P1dB 11 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 5000; 数值: 2000–5000; 单位: MHz

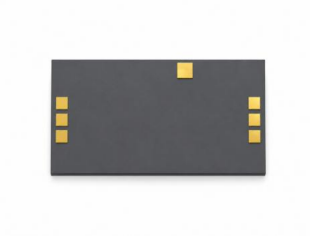
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 11; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 12; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 30; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-32000-52000-NF1p8T

32000–52000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 1.8 dB (典型值)

32000–52000 MHz; NF 1.8 dB (典型值); 小信号增益 26 dB (典型值); P1dB 5 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 32000; 最大值: 52000; 数值: 32000–52000; 单位: MHz

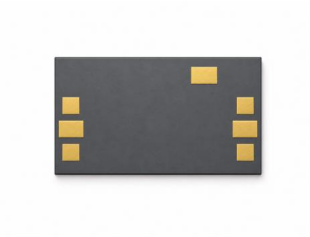
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 5; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 26; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-8000-12000-P1DB16T

8000–12000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 16 dBm (典型值)

8000–12000 MHz; P1dB 16 dBm (典型值); 小信号增益 24 dB (典型值); NF 1.7 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

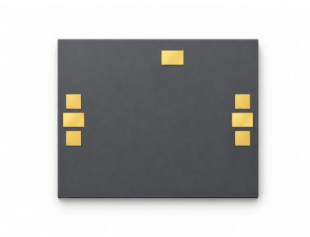
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 16; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 24; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-700-5000-P1DB19T

700–5000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 19 dBm (典型值)

700–5000 MHz; P1dB 19 dBm (典型值); 小信号增益 14 dB (典型值); NF 2.5 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 700; 最大值: 5000; 数值: 700–5000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 19; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 14; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-2700-3500-P1DB23p5T

2700–3500 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 23.5 dBm (典型值)

2700–3500 MHz; P1dB 23.5 dBm (典型值); 小信号增益 28 dB (典型值); NF 3.5 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

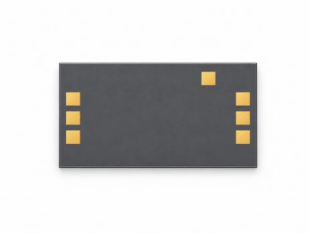
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 23.5; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 25; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 28; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-D

14000–18000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 23 dBm (典型值)

14000–18000 MHz; P1dB 23 dBm (典型值); 小信号增益 19 dB (典型值); NF 5.5 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

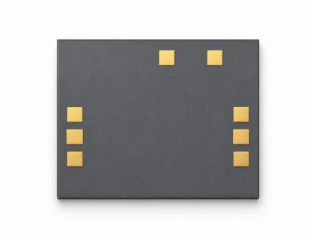
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 23; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 24; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 19; 最大值: 23; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-5000-20000-P1DB20T

5000–20000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 20 dBm (典型值)

5000–20000 MHz; P1dB 20 dBm (典型值); 小信号增益 21 dB (典型值); NF 6.5 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 20000; 数值: 5000–20000; 单位: MHz

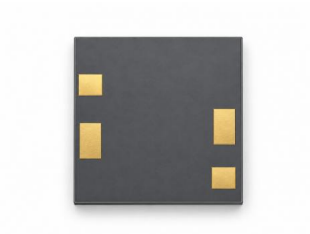
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 20; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 21; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 21; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-DC-6000-P1DB22p8T

DC–6000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 22.8 dBm (典型值)

DC–6000 MHz; P1dB 22.8 dBm (典型值); 小信号增益 21 dB (典型值); NF 1.8 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: DC; 最大值: 6000; 数值: DC–6000; 单位: MHz

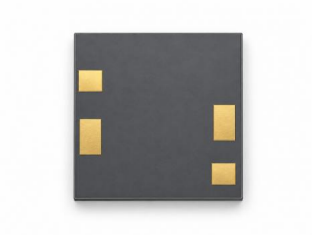
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 22.8; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 21; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-DC-6000-P1DB21T

DC–6000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 21 dBm (典型值)

DC–6000 MHz; P1dB 21 dBm (典型值); 小信号增益 20 dB (典型值); NF 1 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: DC; 最大值: 6000; 数值: DC–6000; 单位: MHz

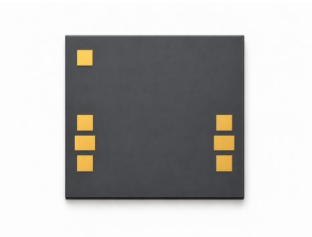
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 21; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 20; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±1; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-800-2000-P1DB15T

800–2000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 15 dBm (典型值)

800–2000 MHz; P1dB 15 dBm (典型值); 小信号增益 17 dB (典型值); NF 1.4 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 800; 最大值: 2000; 数值: 800–2000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 15; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 17; 单位: dB

小信号增益平坦度: 符号: ΔGain; 典型值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-2000-7000-P1DB23p5T

2000–7000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 23.5 dBm (典型值)

2000–7000 MHz; P1dB 23.5 dBm (典型值); 小信号增益 21 dB (典型值); NF 5 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 7000; 数值: 2000–7000; 单位: MHz

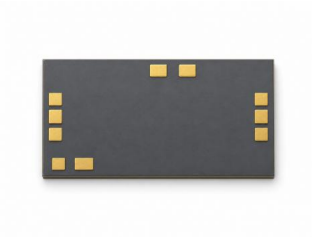
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 23.5; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 24.5; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 21; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-8000-12000-PS28T

8000–12000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — PSAT 28 dBm (典型值)

8000–12000 MHz; PSAT 28 dBm (典型值); 小信号增益 21 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

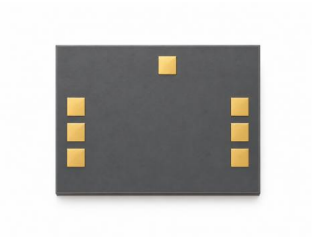
饱和输出功率: 最小值: 27.8; 典型值: 28; 单位: dBm

功率增益: 典型值: 19; 单位: dB

功率附加效率: 典型值: 40; 单位: %

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = -0.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-4000-9000-P1DB17T

4000–9000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 17 dBm (典型值)

4000–9000 MHz; P1dB 17 dBm (典型值); 小信号增益 13 dB (典型值); NF 3.5 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 9000; 数值: 4000–9000; 单位: MHz

输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 17; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 18; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 13; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-2000-18000-P1DB16T

2000–18000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 16 dBm (典型值)

2000–18000 MHz; P1dB 16 dBm (典型值); 小信号增益 21 dB (典型值); NF 3 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 18000; 数值: 2000–18000; 单位: MHz

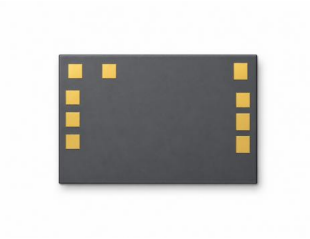
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 16; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 17; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 21; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-6000-12000-P1DB23T

6000–12000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 23 dBm (典型值)

6000–12000 MHz; P1dB 23 dBm (典型值); 小信号增益 23 dB (典型值); NF 5 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 12000; 数值: 6000–12000; 单位: MHz

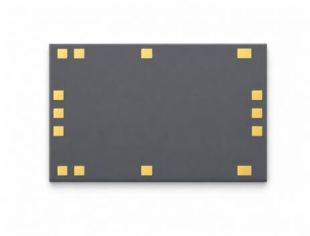
输出1 dB压缩点功率: 符号: P1dB; 典型值: 23; 单位: dBm

饱和输出功率: 符号: Psat; 数值: 23.8; 单位: dBm

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 23; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-24000-31000-PS25T

24000–31000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — PSAT 25 dBm (典型值)

24000–31000 MHz; PSAT 25 dBm (典型值); 小信号增益 22 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 24000; 最大值: 31000; 数值: 24000–31000; 单位: MHz

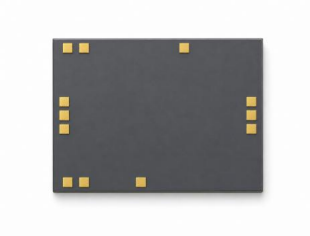
小信号增益: 典型值: 22; 单位: dB

饱和输出功率: 典型值: 25; 单位: dBm

功率增益: 典型值: 20; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 160 mA

产品详情　产品规格书



LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB24T

8000–18000 MHz GaAs MMIC 双向放大器裸片 — Rx / Tx P1dB 24 dBm (典型值)

8000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 24 dBm (典型值); 小信号增益 21 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 18000; 数值: 8000–18000; 单位: MHz

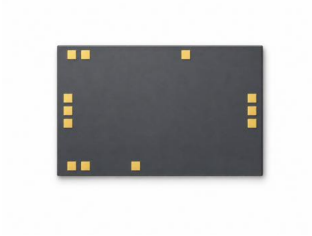
输出1 dB压缩点功率 (Rx): 典型值: 24; 单位: dBm

饱和输出功率 (Rx): 典型值: 24.5; 单位: dBm

小信号增益 (Rx): 典型值: 21; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB21T

6000–18000 MHz GaAs MMIC 双向放大器裸片 — Rx / Tx P1dB 21 dBm (典型值)

6000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 21 dBm (典型值); 小信号增益 19 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

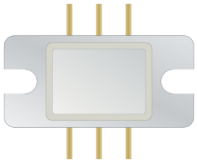
输出1 dB压缩点功率 (Rx): 典型值: 21; 单位: dBm

饱和输出功率 (Rx): 典型值: 22; 单位: dBm

小信号增益 (Rx): 典型值: 19; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-6000-PS40T

2000–6000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 40 dBm (典型值)

2000–6000 MHz; PSAT 40 dBm (典型值); 功率增益 22 dB (典型值); PAE 38 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

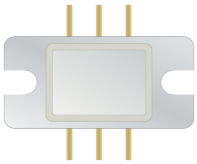
饱和输出功率: 最小值: 39.5; 典型值: 40; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 21.5; 典型值: 22; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 32; 典型值: 38; 单位: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-7500-10500-PS48T

7500–10500 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 48 dBm (典型值)

7500–10500 MHz; PSAT 48 dBm (典型值); 功率增益 24 dB (典型值); PAE 40 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 7500; 最大值: 10500; 数值: 7500–10500; 单位: MHz

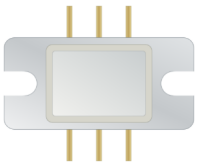
饱和输出功率: 最小值: 47.5; 典型值: 48; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 23.5; 典型值: 24; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 32; 典型值: 40; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; D = 10%; Pin = 24 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-8500-PS41T

2000–8500 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 41 dBm (典型值)

2000–8500 MHz; PSAT 41 dBm (典型值); 功率增益 15 dB (典型值); PAE 35 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 8500; 数值: 2000–8500; 单位: MHz

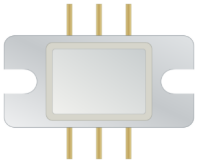
饱和输出功率: 最小值: 40.3; 典型值: 41; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 14.3; 典型值: 15; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 25; 典型值: 35; 单位: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2500-6200-PS44p5T

2500–6200 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 44.5 dBm (典型值)

2500–6200 MHz; PSAT 44.5 dBm (典型值); 功率增益 16.5 dB (典型值); PAE 40 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2500; 最大值: 6200; 数值: 2500–6200; 单位: MHz

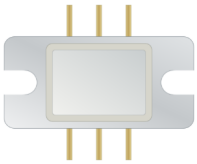
饱和输出功率: 最小值: 44; 典型值: 44.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 16; 典型值: 16.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 35; 典型值: 40; 单位: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-5000-6000-PS47T

5000–6000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 47 dBm (典型值)

5000–6000 MHz; PSAT 47 dBm (典型值); 功率增益 24 dB (典型值); PAE 56 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 6000; 数值: 5000–6000; 单位: MHz

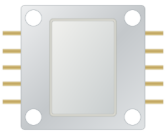
饱和输出功率: 最小值: 46.2; 典型值: 47; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 23.2; 典型值: 24; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 50; 典型值: 56; 单位: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 5%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-13400-14600-PS44p5T

13400–14600 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 44.5 dBm (典型值)

13400–14600 MHz; PSAT 44.5 dBm (典型值); 功率增益 19.5 dB (典型值); PAE 32 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 13400; 最大值: 14600; 数值: 13400–14600; 单位: MHz

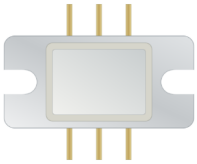
饱和输出功率: 最小值: 43.7; 典型值: 44.5; 单位: dBm

功率增益: 典型值: 19.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 28; 典型值: 32; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-5000-6000-PS49T

5000–6000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 49 dBm (典型值)

5000–6000 MHz; PSAT 49 dBm (典型值); 功率增益 26 dB (典型值); PAE 53 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 6000; 数值: 5000–6000; 单位: MHz

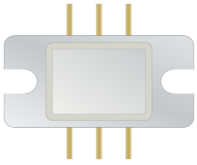
饱和输出功率: 最小值: 48.5; 典型值: 49; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 25.5; 典型值: 26; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 51; 典型值: 53; 单位: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2500-3700-PS41T

2500–3700 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 41 dBm (典型值)

2500–3700 MHz; PSAT 41 dBm (典型值); 功率增益 22 dB (典型值); PAE 47 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2500; 最大值: 3700; 数值: 2500–3700; 单位: MHz

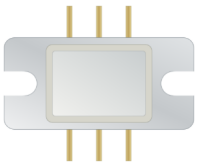
饱和输出功率: 最小值: 40.5; 典型值: 41; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 21.5; 典型值: 22; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 42; 典型值: 47; 单位: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-13600-14500-PS41MIN

13600–14500 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT ≥ 41 dBm

13600–14500 MHz; PSAT ≥ 41 dBm; 功率增益 ≥ 20 dB; PAE 37 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 13600; 最大值: 14500; 数值: 13600–14500; 单位: MHz

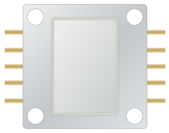
饱和输出功率: 最小值: 41; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 20; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 32; 典型值: 37; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-6000-12000-PS46T

6000–12000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 46 dBm (典型值)

6000–12000 MHz; PSAT 46 dBm (典型值); 功率增益 22 dB (典型值); PAE 30 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 12000; 数值: 6000–12000; 单位: MHz

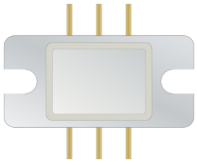
饱和输出功率: 典型值: 46; 单位: dBm

功率增益: 典型值: 22; 单位: dB

功率附加效率: 典型值: 30; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4200-7000-PS41MIN

4200–7000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT ≥ 41 dBm

4200–7000 MHz; PSAT ≥ 41 dBm; 功率增益 ≥ 21 dB; PAE 40 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4200; 最大值: 7000; 数值: 4200–7000; 单位: MHz

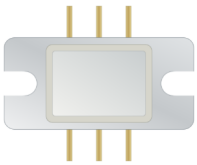
饱和输出功率: 最小值: 41; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 21; 单位: dB

功率附加效率: 典型值: 40; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 20 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4000-5000-PS45MIN

4000–5000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT ≥ 45 dBm

4000–5000 MHz; PSAT ≥ 45 dBm; 功率增益 ≥ 26 dB; PAE 50 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 5000; 数值: 4000–5000; 单位: MHz

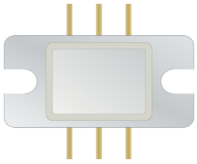
饱和输出功率: 最小值: 45; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 26; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 40; 典型值: 50; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-PA-1200-1600-PS42MIN

1200–1600 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT ≥ 42 dBm

1200–1600 MHz; PSAT ≥ 42 dBm; 功率增益 ≥ 16 dB; PAE 55 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 1200; 最大值: 1600; 数值: 1200–1600; 单位: MHz

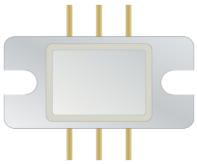
饱和输出功率: 最小值: 42; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 16; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 45; 典型值: 55; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -1.8; D = 10%; Pin = 26 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2500-4000-PS46p5T

2500–4000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 46.5 dBm (典型值)

2500–4000 MHz; PSAT 46.5 dBm (典型值); 功率增益 26.5 dB (典型值); PAE 50 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2500; 最大值: 4000; 数值: 2500–4000; 单位: MHz

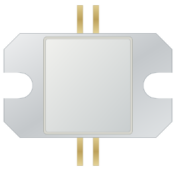
饱和输出功率: 最小值: 46; 典型值: 46.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 25; 典型值: 26.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 45; 典型值: 50; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; D = 10%; Pin = 20 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-C

2700–3500 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 45.5 dBm (典型值)

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (典型值); 功率增益 26.5 dB (典型值); PAE 55 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

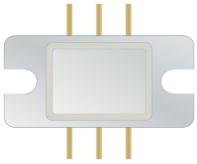
饱和输出功率: 最小值: 44.5; 典型值: 45.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 25.5; 典型值: 26.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 50; 典型值: 55; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4000-8000-PS43T

4000–8000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 43 dBm (典型值)

4000–8000 MHz; PSAT 43 dBm (典型值); 功率增益 20 dB (典型值); PAE 35 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 8000; 数值: 4000–8000; 单位: MHz

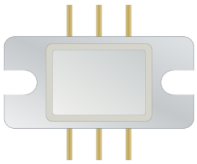
饱和输出功率: 最小值: 42; 典型值: 43; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 19; 典型值: 20; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 30; 典型值: 35; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 23 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-PA-3400-4800-PS43T

3400–4800 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 43 dBm (典型值)

3400–4800 MHz; PSAT 43 dBm (典型值); 功率增益 23 dB (典型值); PAE 45 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 3400; 最大值: 4800; 数值: 3400–4800; 单位: MHz

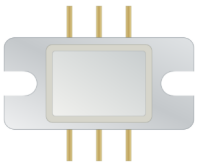
饱和输出功率: 最小值: 42; 典型值: 43; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 22; 典型值: 23; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 35; 典型值: 45; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-9200-10400-PS45T

9200–10400 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 45 dBm (典型值)

9200–10400 MHz; PSAT 45 dBm (典型值); 功率增益 23 dB (典型值); PAE 38 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 9200; 最大值: 10400; 数值: 9200–10400; 单位: MHz

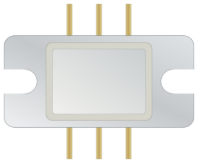
饱和输出功率: 最小值: 44.7; 典型值: 45; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 22.7; 典型值: 23; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 35; 典型值: 38; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 22 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-8000-PS42p5T

2000–8000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 42.5 dBm (典型值)

2000–8000 MHz; PSAT 42.5 dBm (典型值); 功率增益 15.5 dB (典型值); PAE 28 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 8000; 数值: 2000–8000; 单位: MHz

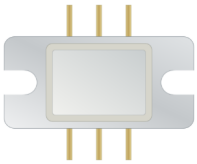
饱和输出功率: 最小值: 40; 典型值: 42.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 13; 典型值: 15.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 25; 典型值: 28; 单位: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-5800-6800-PS46p5T

5800–6800 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 46.5 dBm (典型值)

5800–6800 MHz; PSAT 46.5 dBm (典型值); 功率增益 21 dB (典型值); PAE 40 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 5800; 最大值: 6800; 数值: 5800–6800; 单位: MHz

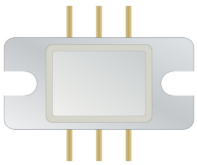
饱和输出功率: 最小值: 45.5; 典型值: 46.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 20; 典型值: 21; 单位: dB

功率附加效率: 典型值: 40; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 26 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-6000-PS44p5T

2000–6000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 44.5 dBm (典型值)

2000–6000 MHz; PSAT 44.5 dBm (典型值); 功率增益 17.5 dB (典型值); PAE 35 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

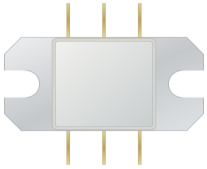
饱和输出功率: 最小值: 44; 典型值: 44.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 17; 典型值: 17.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 30; 典型值: 35; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 27 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS42T-C

8000–12000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 42 dBm (典型值)

8000–12000 MHz; PSAT 42 dBm (典型值); 功率增益 21 dB (典型值); PAE 38 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

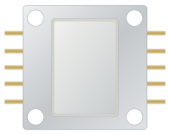
饱和输出功率: 典型值: 42; 单位: dBm

功率增益: 典型值: 21; 单位: dB

功率附加效率: 典型值: 38; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 21 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS46T

8000–12000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 46 dBm (典型值)

8000–12000 MHz; PSAT 46 dBm (典型值); 功率增益 24 dB (典型值); PAE 37 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

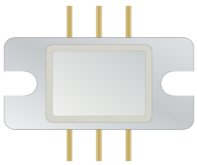
饱和输出功率: 典型值: 46; 单位: dBm

功率增益: 典型值: 24; 单位: dB

功率附加效率: 典型值: 37; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4000-8000-PS36p5T

4000–8000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 36.5 dBm (典型值)

4000–8000 MHz; PSAT 36.5 dBm (典型值); 功率增益 19.5 dB (典型值); PAE 35 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 8000; 数值: 4000–8000; 单位: MHz

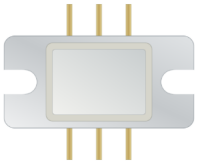
饱和输出功率: 最小值: 36; 典型值: 36.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 19; 典型值: 19.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 30; 典型值: 35; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 17 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-4000-8000-PS47T

4000–8000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 47 dBm (典型值)

4000–8000 MHz; PSAT 47 dBm (典型值); 功率增益 19 dB (典型值); PAE 40 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 8000; 数值: 4000–8000; 单位: MHz

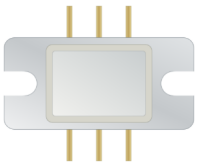
饱和输出功率: 最小值: 46.5; 典型值: 47; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 18.5; 典型值: 19; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 32; 典型值: 40; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 28 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2000-6000-PS43T-C

2000–6000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 43 dBm (典型值)

2000–6000 MHz; PSAT 43 dBm (典型值); 功率增益 26 dB (典型值); PAE 45 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

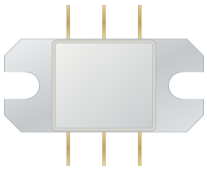
饱和输出功率: 最小值: 42.5; 典型值: 43; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 25.5; 典型值: 26; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 35; 典型值: 45; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 17 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

产品详情　产品规格书



LCI-PA-8000-12000-PS39T-C

8000–12000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 39 dBm (典型值)

8000–12000 MHz; PSAT 39 dBm (典型值); 功率增益 18 dB (典型值); PAE 40 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

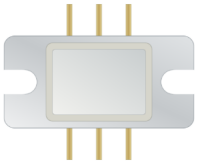
饱和输出功率: 最小值: 37; 典型值: 39; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 17; 典型值: 18; 单位: dB

功率附加效率: 典型值: 40; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.4, -2.4] V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-9000-11000-PS36MIN

9000–11000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT ≥ 36 dBm

9000–11000 MHz; PSAT ≥ 36 dBm; 功率增益 ≥ 23 dB; PAE 40 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 9000; 最大值: 11000; 数值: 9000–11000; 单位: MHz

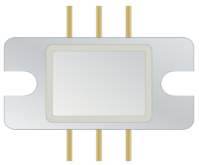
饱和输出功率: 最小值: 36; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 23; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 33; 典型值: 40; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.4, -2.4] V; Pin = 13 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-PA-2700-3500-PS31p5T

2700–3500 MHz GaAs 封装功率放大器 — PSAT 31.5 dBm (典型值)

2700–3500 MHz; PSAT 31.5 dBm (典型值); 功率增益 36.5 dB (典型值); PAE 40 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

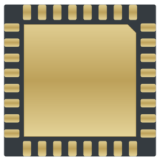
饱和输出功率: 最小值: 31; 典型值: 31.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 36; 典型值: 36.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 37; 典型值: 40; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 8 V; VGS ∈ [-0.8, -0.6] V; Pin = -5 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCI-PA-10-1100-PS40MIN

10–1100 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT ≥ 40 dBm

10–1100 MHz; PSAT ≥ 40 dBm; 功率增益 ≥ 13 dB; PAE ≥ 60 %.

工作频率: 符号: f; 最小值: 10; 最大值: 1100; 数值: 10–1100; 单位: MHz

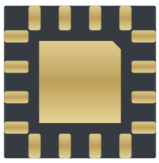
饱和输出功率: 最小值: 40; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 13; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 60; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-4000-12000-NF0p8T

4000–12000 MHz 封装低噪声放大器 — NF 0.8 dB (典型值)

4000–12000 MHz; 小信号增益 34 dB (典型值); 噪声系数 0.8 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 7 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 4000; 最大值: 12000; 数值: 4000–12000; 单位: MHz

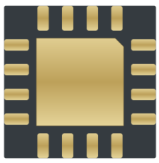
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 34; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 0.8; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 7; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-2000-5000-NF0p65T-P1DB10p5T

2000–5000 MHz 封装低噪声放大器 — NF 0.65 dB (典型值)

2000–5000 MHz; 小信号增益 29 dB (典型值); 噪声系数 0.65 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 10.5 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 5000; 数值: 2000–5000; 单位: MHz

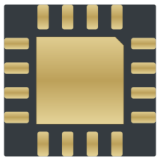
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 29; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 0.65; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 10.5; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-2000-5000-NF0p65T-P1DB14T

2000–5000 MHz 封装低噪声放大器 — NF 0.65 dB (典型值)

2000–5000 MHz; 小信号增益 29 dB (典型值); 噪声系数 0.65 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 14 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 5000; 数值: 2000–5000; 单位: MHz

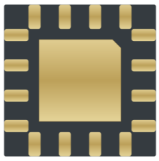
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 29; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 0.65; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 14; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG26T

8000–12000 MHz 封装低噪声放大器 — NF 0.9 dB (典型值)

8000–12000 MHz; 小信号增益 26 dB (典型值); 噪声系数 0.9 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 ≥ 7 dBm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

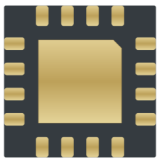
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 26; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 0.9; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 最小值: 7; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -30 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-LNA-6000-20000-NF1p5T

6000–20000 MHz 封装低噪声放大器 — NF 1.5 dB (典型值)

6000–20000 MHz; 小信号增益 26 dB (典型值); 噪声系数 1.5 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 -2 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 20000; 数值: 6000–20000; 单位: MHz

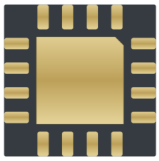
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 26; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 1.5; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: -2; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-2000-7000-P1DB23T

2000–7000 MHz 封装射频增益放大器 — P1dB 23 dBm (典型值)

2000–7000 MHz; 小信号增益 20 dB (典型值); 噪声系数 6 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 23 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 7000; 数值: 2000–7000; 单位: MHz

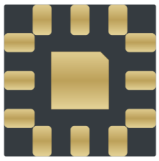
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 20; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 6; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 23; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-100-6000-P1DB20T

100–6000 MHz 封装射频增益放大器 — P1dB 20 dBm (典型值)

100–6000 MHz; 小信号增益 17 dB (典型值); 噪声系数 1.2 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 20 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 6000; 数值: 100–6000; 单位: MHz

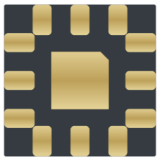
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 17; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 1.2; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 20; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-100-6000-P1DB22T

100–6000 MHz 封装射频增益放大器 — P1dB 22 dBm (典型值)

100–6000 MHz; 小信号增益 20 dB (典型值); 噪声系数 2 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 22 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 6000; 数值: 100–6000; 单位: MHz

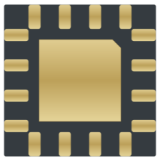
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 20; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 2; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 22; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-800-2000-P1DB14p5T

800–2000 MHz 封装射频增益放大器 — P1dB 14.5 dBm (典型值)

800–2000 MHz; 小信号增益 16.5 dB (典型值); 噪声系数 1.6 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 14.5 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 800; 最大值: 2000; 数值: 800–2000; 单位: MHz

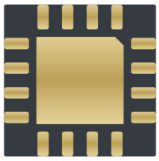
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 16.5; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 1.6; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 14.5; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-2700-3500-P1DB23T

2700–3500 MHz 封装射频增益放大器 — P1dB 23 dBm (典型值)

2700–3500 MHz; 小信号增益 27 dB (典型值); 噪声系数 4 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 23 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

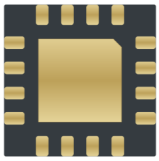
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 27; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 4; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 23; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-5000-20000-P1DB19p5T

5000–20000 MHz 封装射频增益放大器 — P1dB 19.5 dBm (典型值)

5000–20000 MHz; 小信号增益 20 dB (典型值); 噪声系数 6 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 19.5 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 20000; 数值: 5000–20000; 单位: MHz

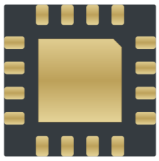
小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 20; 单位: dB

噪声系数: 符号: NF; 典型值: 6; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 19.5; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-C

14000–18000 MHz 封装射频增益放大器 — P1dB 23 dBm (典型值)

14000–18000 MHz; 小信号增益 18 dB (典型值); 噪声系数 6 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 23 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

小信号增益: 符号: Gain; 典型值: 18; 单位: dB

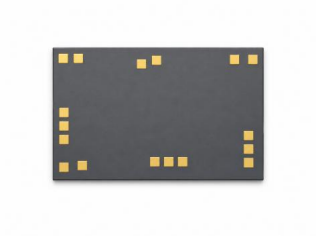
噪声系数: 符号: NF; 典型值: 6; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 符号: P_1; 典型值: 23; 单位: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

产品详情　产品规格书

射频前端芯片



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T

5000–13000 MHz GaN T/R MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 31 dBm (典型值); 功率增益: 18 dB (典型值); PAE: 30 % (典型值). 裸片尺寸: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 13000; 数值: 5000–13000; 单位: MHz

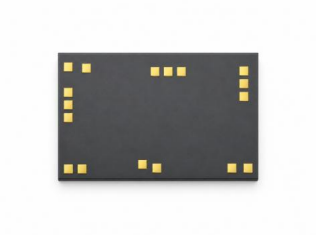
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 31; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 18; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T-M

5000–13000 MHz GaN T/R MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 31 dBm (典型值); 功率增益: 18 dB (典型值); PAE: 30 % (典型值). 裸片尺寸: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 13000; 数值: 5000–13000; 单位: MHz

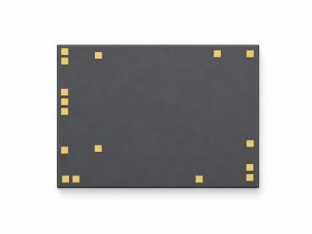
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 31; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 18; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±1.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

产品详情　产品规格书



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T

8000–12000 MHz GaN T/R MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 41 dBm (典型值); 功率增益: 25 dB (典型值); PAE: 38 % (典型值). 裸片尺寸: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

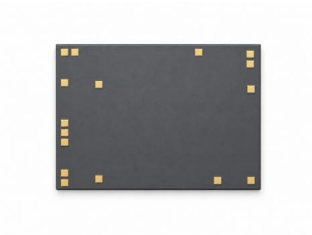
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 41; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 25; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T-M

8000–12000 MHz GaN T/R MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 41 dBm (典型值); 功率增益: 25 dB (典型值); PAE: 38 % (典型值). 裸片尺寸: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

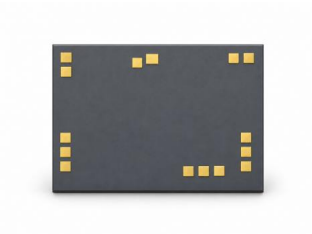
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 41; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 25; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T

9000–10000 MHz GaN T/R MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 35 dBm (典型值); 功率增益: 21 dB (典型值); PAE: 35 % (典型值). 裸片尺寸: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 9000; 最大值: 10000; 数值: 9000–10000; 单位: MHz

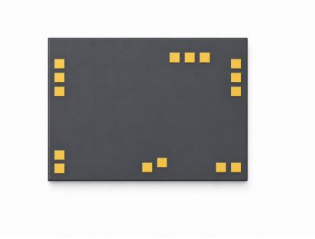
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 35; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 21; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.2; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M

9000–10000 MHz GaN T/R MMIC 功率放大器裸片

PSAT: 35 dBm (典型值); 功率增益: 21 dB (典型值); PAE: 35 % (典型值). 裸片尺寸: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 9000; 最大值: 10000; 数值: 9000–10000; 单位: MHz

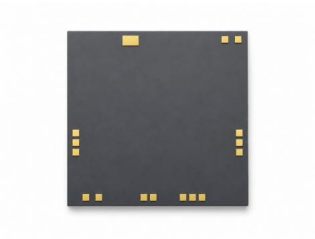
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 35; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 典型值: 21; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 最大值: ±0.2; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

产品详情　产品规格书



LCI-TRPA-300-6000-PS39T

300–6000 MHz GaN T/R MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 38.7 dBm (最小值) / 39 dBm (典型值) / 40.5 dBm (最大值); 功率增益: 10.7 dB (最小值) / 11 dB (典型值) / 12.5 dB (最大值); PAE: 30 % (最小值) / 35 % (典型值) / 53 % (最大值). 裸片尺寸: 3.1 × 3.1 × 0.1 mm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 300; 最大值: 6000; 数值: 300–6000; 单位: MHz

饱和输出功率: 符号: Psat; 最小值: 38.7; 典型值: 39; 最大值: 40.5; 单位: dBm

功率增益: 符号: Gp; 最小值: 10.7; 典型值: 11; 最大值: 12.5; 单位: dB

功率增益平坦度: 符号: ΔGp; 典型值: ±0.9; 单位: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; 脉冲

产品详情　产品规格书



LCI-APC-8000-12000-D-G7p5MIN

8000–12000 MHz GaAs MMIC 幅相控制 RF 前端裸片

移相步进: 5.625 °; 衰减范围: 0–31.5 dB; 输出1 dB压缩点功率: 11 dBm (最小值) / 13 dBm (典型值). 裸片尺寸: 3.8 × 4.7 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

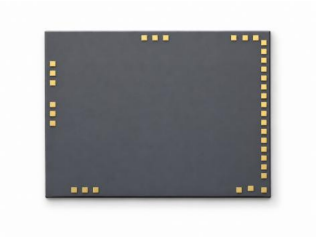
小信号增益: 最小值: 7.5; 最大值: 10; 数值: TX / RX; 单位: dB

隔离度: 最小值: 35; 单位: dB

衰减范围: 数值: 0–31.5; 单位: dB

TA = +25 °C; f(Typ) = 10000 MHz; f(Min/Max) = 8000–12000 MHz

产品详情　产品规格书



LCI-APC-7000-13000

7000–13000 MHz GaAs MMIC 幅相控制 RF 前端裸片

移相步进: 5.625 ° (典型值); 衰减范围: 0.5 dB (最小值) / 31.5 dB (最大值); 小信号增益: 12 dB (典型值) (RX). 裸片尺寸: 4.55 × 3.54 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 7000; 最大值: 13000; 数值: 7000–13000; 单位: MHz

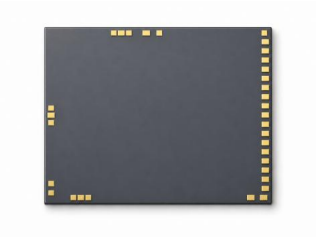
小信号增益: 典型值: 12; 数值: RX; 单位: dB

输出1 dB压缩点功率: 典型值: 11; 数值: RX; 单位: dBm

饱和输出功率: 典型值: 24; 数值: TX; 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-APC-5000-6000

5000–6000 MHz GaAs MMIC 幅相控制 RF 前端裸片 — Rx 13 dB / Tx 27 dB (典型值)

5000–6000 MHz; Rx 13 dB / Tx 27 dB (典型值); Rx P1dB ≥ 10 dBm; Tx PSAT ≥ 23 dBm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 6000; 数值: 5000–6000; 单位: MHz

移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

衰减范围: 最小值: 0.5; 最大值: 31.5; 单位: dB

小信号增益 (Rx): 典型值: 13; 单位: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-APC-8000-12000-D-RXG10T

8000–12000 MHz GaAs MMIC 幅相控制 RF 前端裸片 — Rx 10 dB / Tx 26 dB (典型值)

8000–12000 MHz; Rx 10 dB / Tx 26 dB (典型值); Rx P1dB ≥ 13.5 dBm; Tx PSAT ≥ 25 dBm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

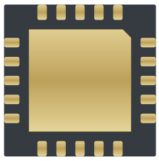
移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

衰减范围: 最小值: 0.5; 最大值: 31.5; 单位: dB

小信号增益 (Rx): 典型值: 10; 单位: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

产品详情　产品规格书



LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB23T

8000–18000 MHz 双向射频前端IC — RX / TX P1dB 23 dBm (典型值)

8000–18000 MHz; 小信号增益 (Rx) 20 dB (典型值); 小信号增益 (Tx) 20 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 (Rx) 23 dBm (典型值); 输出1 dB压缩点功率 (Tx) 23 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 18000; 数值: 8000–18000; 单位: MHz

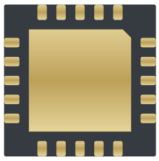
小信号增益 (Rx): 符号: Gain; 典型值: 20; 单位: dB; 备注: RX

小信号增益 (Tx): 符号: Gain; 典型值: 20; 单位: dB; 备注: TX

输出1 dB压缩点功率 (Rx): 符号: P_1; 典型值: 23; 单位: dBm; 备注: RX

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB20T

6000–18000 MHz 双向射频前端IC — RX / TX P1dB 20 dBm (典型值)

6000–18000 MHz; 小信号增益 (Rx) 18 dB (典型值); 小信号增益 (Tx) 18 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率 (Rx) 20 dBm (典型值); 输出1 dB压缩点功率 (Tx) 20 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

小信号增益 (Rx): 符号: Gain; 典型值: 18; 单位: dB; 备注: RX

小信号增益 (Tx): 符号: Gain; 典型值: 18; 单位: dB; 备注: TX

输出1 dB压缩点功率 (Rx): 符号: P_1; 典型值: 20; 单位: dBm; 备注: RX

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

产品详情　产品规格书

裸片与芯片级射频器件



LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

12000–18000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.6 dB (典型值) / 0.7 dB (最大值); 限幅电平: 16.5 dBm (典型值) / 17.5 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 43 dBm (最大值) (τ = 1 ms; D = 20%). 裸片尺寸: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 12000; 最大值: 18000; 数值: 12000–18000; 单位: MHz

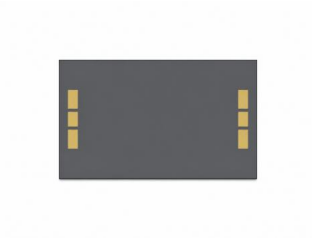
插入损耗: 典型值: 0.6; 最大值: 0.7; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.4

输出驻波比: 典型值: 1.4

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-5000-6000

5000–6000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.45 dB (典型值) / 0.5 dB (最大值); 限幅电平: 18.5 dBm (典型值) / 19.5 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 49 dBm (最大值) (τ = 2 ms; D = 20%); 最大脉冲输入功率: 50 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 5000; 最大值: 6000; 数值: 5000–6000; 单位: MHz

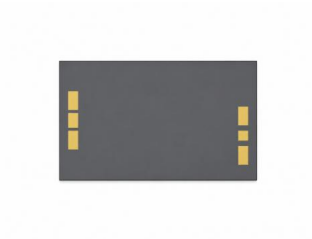
插入损耗: 典型值: 0.45; 最大值: 0.5; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.5 dB (典型值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 42 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

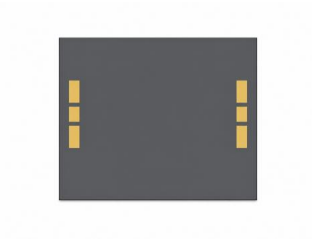
插入损耗: 典型值: 0.5; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

2000–6000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.3 dB (典型值) / 0.4 dB (最大值); 限幅电平: 15 dBm (典型值) / 16 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 43 dBm (最大值) (τ = 200 µs; D = 20%). 裸片尺寸: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

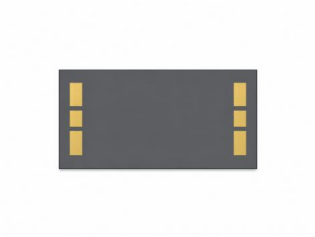
插入损耗: 典型值: 0.3; 最大值: 0.4; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.4

输出驻波比: 典型值: 1.4

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

6000–18000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.8 dB (典型值); 限幅电平: 16.5 dBm (典型值) / 17.5 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 42 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

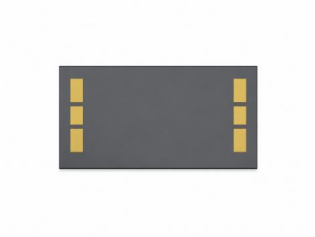
插入损耗: 典型值: 0.8; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.6

输出驻波比: 典型值: 1.6

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

6000–18000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.6 dB (典型值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 41 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.6; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.5

输出驻波比: 典型值: 1.5

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.8 dB (典型值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 48 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%); 最大输入功率: 46 dBm (最大值) (CW). 裸片尺寸: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.8; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.5

输出驻波比: 典型值: 1.5

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

DC–14000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.4 dB (典型值) / 0.5 dB (最大值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大输入功率: 37 dBm (最大值) (CW). 裸片尺寸: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 14000; 数值: DC–14000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.4; 最大值: 0.5; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.6 dB (典型值) / 0.7 dB (最大值); 限幅电平: 15 dBm (典型值) / 16 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 45 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.6; 最大值: 0.7; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.6

输出驻波比: 典型值: 1.6

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.3 dB (典型值); 限幅电平: 17 dBm (典型值) / 18 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 37 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.3; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.3 dB (典型值); 限幅电平: 17 dBm (典型值) / 18 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 37 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.3; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

10000–18000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.8 dB (典型值); 限幅电平: 17 dBm (典型值) / 18 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 45 dBm (最大值) (τ = 200 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 10000; 最大值: 18000; 数值: 10000–18000; 单位: MHz

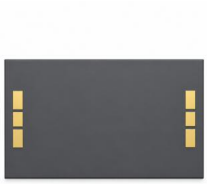
插入损耗: 典型值: 0.8; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.6; 最大值: 1.8

输出驻波比: 典型值: 1.6; 最大值: 1.8

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

DC–6000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.35 dB (典型值) / 0.4 dB (最大值); 限幅电平: 15 dBm (典型值) / 16 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 45 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 6000; 数值: DC–6000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.35; 最大值: 0.4; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.4; 最大值: 1.5

输出驻波比: 典型值: 1.4; 最大值: 1.5

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

2000–4000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.4 dB (典型值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 51 dBm (最大值) (τ = 100 µs; D = 10%); 最大输入功率: 48 dBm (最大值) (CW). 裸片尺寸: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 4000; 数值: 2000–4000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.4; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-R15OHM

15 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 15 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.35 A (典型值); 最大承受电流: 0.8 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 1

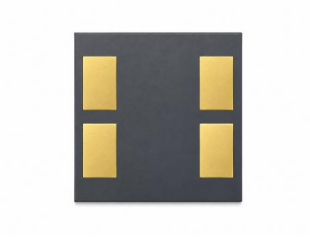
端口数量: 数值: 2

电阻值: 典型值: 15; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 20 / 20 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.165 / 0.165 A (典型值); 最大承受电流: 0.33 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 2

端口数量: 数值: 4

电阻值: 典型值: 20 / 20; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-R50OHM

50 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 50 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.2 A (典型值); 最大承受电流: 0.6 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 1

端口数量: 数值: 2

电阻值: 典型值: 50; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-R1000OHM

1000 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 1000 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.04 A (典型值); 最大承受电流: 0.08 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 1

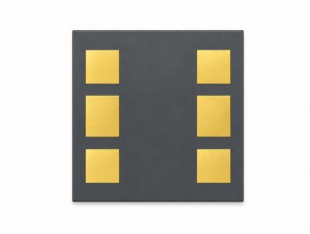
端口数量: 数值: 2

电阻值: 典型值: 1000; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCCAP-C10PF

10 pF GaAs电容裸芯片

电容值: 10 pF (典型值); 耐压: 50 V (典型值). 裸片尺寸: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

电容值: 典型值: 10; 单位: pF; TA = +25 °C

耐压: 典型值: 50; 单位: V; TA = +25 °C

击穿电压: 数值: 80 (Vb); 单位: V

储存温度: 最小值: -65; 最大值: 150; 单位: °C

产品详情　产品规格书



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz GaAs斜率均衡器裸芯片

均衡量: 2 dB; 插入损耗 @ 8000 MHz: 2.6 dB; 插入损耗 @ 12000 MHz: 0.7 dB. 裸片尺寸: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

均衡量: 数值: 2; 单位: dB

插入损耗 @ 8000 MHz: 数值: 2.6; 单位: dB

插入损耗 @ 12000 MHz: 数值: 0.7; 单位: dB

产品详情　产品规格书



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz GaAs斜率均衡器裸芯片

均衡量: 5.5 dB; 插入损耗 @ 2000 MHz: 0.6 dB; 插入损耗 @ 6000 MHz: 6.1 dB. 裸片尺寸: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

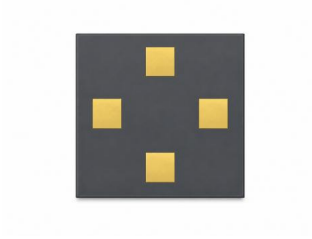
工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

均衡量: 数值: 5.5; 单位: dB

插入损耗 @ 2000 MHz: 数值: 0.6; 单位: dB

插入损耗 @ 6000 MHz: 数值: 6.1; 单位: dB

产品详情　产品规格书



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz GaAs射频交叉跳线裸芯片

插入损耗: 0.4 dB (典型值); 隔离度: 30 dB (典型值); 回波损耗: 20 dB (典型值). 裸片尺寸: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 40000; 数值: DC–40000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.4; 单位: dB

隔离度: 典型值: 30; 单位: dB

回波损耗: 典型值: 20; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCBPF-17000-19000

17000–19000 MHz GaAs 带通滤波器裸片 — IL 2.7 dB (典型值)

17000–19000 MHz; 插入损耗 2.7 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 17000; 最大值: 19000; 数值: 17000–19000; 单位: MHz

中心频率: 典型值: 18000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 2.7; 单位: dB

通带波动: 典型值: 0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

射频开关芯片



LCI-SW-1000-12000-SPDT

1000–12000 MHz GaN SPDT MMIC 开关裸片

插入损耗: 1 dB (典型值); 隔离度: 34 dB (最小值) / 63 dB (最大值); 输入0.2 dB压缩点功率: 43 dBm (典型值). 裸片尺寸: 2.45 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 1000; 最大值: 12000; 数值: 1000–12000; 单位: MHz

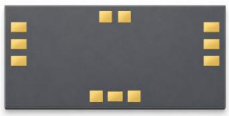
插入损耗: 典型值: 1; 单位: dB

隔离度: 最小值: 34; 最大值: 63; 单位: dB

输入0.2 dB压缩点功率: 典型值: 43; 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-12000-18000-SPDT

12000–18000 MHz GaN SPDT MMIC 开关裸片 — IL 1 dB (典型值)

12000–18000 MHz; 插入损耗 1 dB (典型值); 隔离度 38 dB (典型值); P0.2dB 44 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 12000; 最大值: 18000; 数值: 12000–18000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 1; 最大值: 1.2; 单位: dB

隔离度: 最小值: 36; 典型值: 38; 单位: dB

输入0.2 dB压缩点功率: 典型值: 44; 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-32000-38000-SPDT

32000–38000 MHz SPDT MMIC 开关裸片 — IL 1 dB (典型值)

32000–38000 MHz; 插入损耗 1 dB (典型值); 隔离度 20 dB (典型值); P0.2dB 42 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 32000; 最大值: 38000; 数值: 32000–38000; 单位: MHz

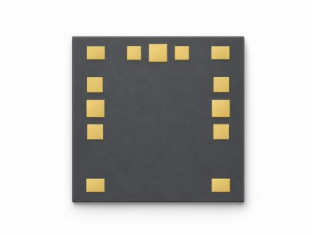
插入损耗: 典型值: 1; 单位: dB

隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入0.2 dB压缩点功率: 典型值: 42; 单位: dBm

Von = -28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-2000-18000-SPDT

2000–18000 MHz SPDT MMIC 开关裸片 — IL 0.9 dB (典型值)

2000–18000 MHz; 插入损耗 0.9 dB (典型值); 隔离度 23 dB (典型值); P0.2dB 37 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 18000; 数值: 2000–18000; 单位: MHz

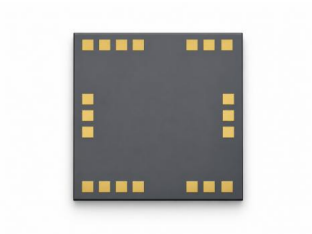
插入损耗: 典型值: 0.9; 单位: dB

隔离度: 典型值: 23; 单位: dB

输入0.2 dB压缩点功率: 典型值: 37; 单位: dBm

Von = +28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-100-20000-SP3T-D

100–20000 MHz GaAs SP3T MMIC 开关裸片 — IL ≤ 2.8 dB (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; 插入损耗 (100–2000 MHz) ≤ 1.4 dB; 隔离度 (100–2000 MHz) ≤ 65 dB.

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 20000; 数值: 100–20000; 单位: MHz

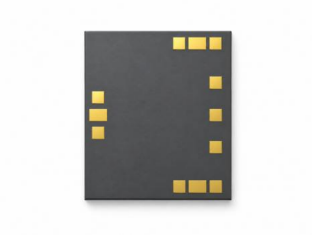
插入损耗 (100–2000 MHz): 最大值: 1.4; 数值: f = 100–2000 MHz; 单位: dB

插入损耗 (2000–20000 MHz): 最大值: 2.8; 数值: f = 2000–20000 MHz; 单位: dB

隔离度 (100–2000 MHz): 最大值: 65; 数值: f = 100–2000 MHz; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-100-20000-SPDT-D-IL1p6T

100–20000 MHz GaAs SPDT MMIC 开关裸片 — IL 1.6 dB (典型值)

100–20000 MHz; 插入损耗 1.6 dB (典型值); 隔离度 45 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 20000; 数值: 100–20000; 单位: MHz; TA = +25 °C

插入损耗: 典型值: 1.6; 单位: dB; TA = +25 °C

隔离度: 典型值: 45; 单位: dB; TA = +25 °C

负电源静态电流: 典型值: 0.0012; 单位: A

产品详情　产品规格书



LCI-SW-8000-12000-SPDT

8000–12000 MHz GaN SPDT MMIC 开关裸片 — IL 0.9 dB (典型值)

8000–12000 MHz; 插入损耗 0.9 dB (典型值); 隔离度 45 dB (典型值); P0.2dB 46 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

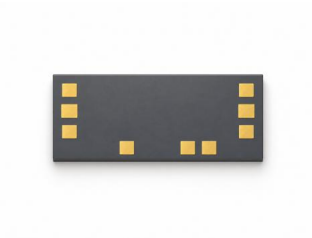
插入损耗: 典型值: 0.9; 单位: dB

隔离度: 典型值: 45; 最大值: 50; 单位: dB

输入0.2 dB压缩点功率: 典型值: 46; 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-100-20000-SPST-D

100–20000 MHz GaAs SPST MMIC 开关裸片 — IL ≤ 1.2 dB

100–20000 MHz; 插入损耗 ≤ 1.2 dB; 隔离度 60 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 20000; 数值: 100–20000; 单位: MHz

插入损耗: 最大值: 1.2; 单位: dB

隔离度: 典型值: 60; 单位: dB

输入/输出驻波比 (导通): 典型值: 1.1

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-2700-3500-SPDT

2700–3500 MHz GaN SPDT MMIC 开关裸片 — IL 0.7 dB (典型值)

2700–3500 MHz; 插入损耗 0.7 dB (典型值); 隔离度 41 dB (典型值); P0.2dB 51 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.7; 单位: dB

隔离度: 典型值: 41; 最大值: 43; 单位: dB

输入0.2 dB压缩点功率: 典型值: 51; 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-100-6000-SPDT

100–6000 MHz GaN SPDT MMIC 开关裸片 — IL 0.7 dB (典型值)

100–6000 MHz; 插入损耗 0.7 dB (典型值); 隔离度 45 dB (典型值); P0.2dB 47 dBm (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 6000; 数值: 100–6000; 单位: MHz

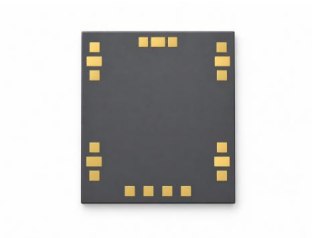
插入损耗: 典型值: 0.7; 最大值: 0.8; 单位: dB

隔离度: 典型值: 45; 单位: dB

输入0.2 dB压缩点功率: 典型值: 47; 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-100-20000-SP4T-D

100–20000 MHz GaAs SP4T MMIC 开关裸片 — IL −2 dB (典型值)

100–20000 MHz; 插入损耗 -2 dB (典型值); 隔离度 -50 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 20000; 数值: 100–20000; 单位: MHz

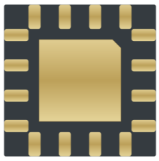
插入损耗: 典型值: -2; 单位: dB

隔离度: 典型值: -50; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-100-20000-SPST-C

100–20000 MHz 射频开关IC — SPST; TTL

100–20000 MHz; SPST; 插入损耗 -1.8 dB (典型值); 隔离度 60 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 20000; 数值: 100–20000; 单位: MHz

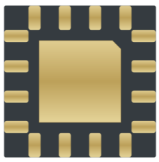
插入损耗: 符号: IL; 典型值: -1.8; 单位: dB

隔离度: 符号: ISO; 典型值: 60; 单位: dB

输入/输出驻波比 (导通): 典型值: 1.14

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-100-20000-SP3T-C

100–20000 MHz 射频开关IC — SP3T; TTL

100–20000 MHz; SP3T; 插入损耗 -3.1 dB (典型值); 隔离度 50 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 20000; 数值: 100–20000; 单位: MHz

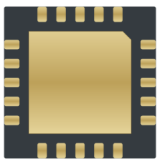
插入损耗: 符号: IL; 典型值: -3.1; 单位: dB

隔离度: 符号: ISO; 典型值: 50; 单位: dB

输入/输出驻波比 (导通): 典型值: 1.14

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-100-20000-SP4T-C

100–20000 MHz 射频开关IC — SP4T; TTL

100–20000 MHz; SP4T; 插入损耗 -2.6 dB (典型值); 隔离度 -50 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 20000; 数值: 100–20000; 单位: MHz

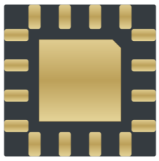
插入损耗: 符号: IL; 典型值: -2.6; 单位: dB

隔离度: 符号: ISO; 典型值: -50; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-SW-100-20000-SPDT-C

100–20000 MHz 射频开关IC — SPDT; TTL

100–20000 MHz; SPDT; 插入损耗 -2.2 dB (典型值); 隔离度 -45 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 20000; 数值: 100–20000; 单位: MHz

插入损耗: 符号: IL; 典型值: -2.2; 单位: dB

隔离度: 符号: ISO; 典型值: -45; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.22

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

射频波束成形芯片



LCI-BF-14000-18000-4CH

14000–18000 MHz 四通道 SiGe T/R 波束赋形裸片

移相步进: 5.625 °; 衰减范围: 0–31.5 dB; 开关时间: 100 ns (最大值). 裸片平面尺寸: 5 × 6.2 mm.

工作频率: 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

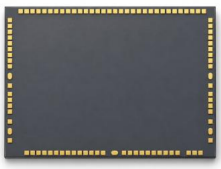
输入/输出驻波比: 典型值: 1.8

移相均方根误差: 最大值: 3; 单位: °

衰减均方根误差: 最大值: 0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-BF-8000-12000-2CH

8000–12000 MHz 双通道 Si T/R 波束赋形裸片

移相步进: 5.625 ° (典型值); 衰减步进: 0.5 dB (典型值). 裸片尺寸: 3.6 × 2.7 × 0.15 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

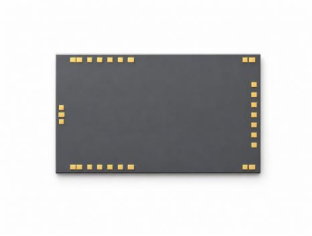
移相控制位数: 数值: 6; 单位: bit

衰减控制位数: 数值: 6; 单位: bit

移相范围: 最小值: 0; 最大值: 360; 单位: °

CLK = 50 MHz; RFVDD = AVDD = DVDD = 3.3 V; TA = +27 °C

产品详情　产品规格书



LCI-BF-3700-5000-2CH

3700–5000 MHz 双通道 GaAs MMIC 移相衰减控制裸片 — 2 × 6-bit ϕ / 6-bit ATT

3700–5000 MHz; 插入损耗 -13 dB (典型值); 64态衰减均方根误差 0.2 dB (典型值); 64态移相均方根误差 2 ° (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 3700; 最大值: 5000; 数值: 3700–5000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: -13; 单位: dB

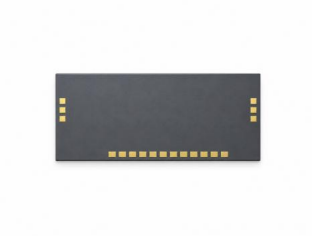
衰减范围: 最大值: 31.5; 单位: dB

64态衰减均方根误差: 典型值: 0.2; 单位: dB

TA = +25 °C; VEE = -5 V; Vd = +5 V

产品详情　产品规格书

射频移相器芯片



LCI-PS-1200-1400-6B-D

1200–1400 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 0.5 ° (最小值) / 0.7 ° (典型值) / 1 ° (最大值); 移相范围: 5.625 ° (最小值) / 354.375 ° (最大值); 插入损耗: ≈5 dB. 裸片尺寸: 4 × 1.7 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 1200; 最大值: 1400; 数值: 1200–1400; 单位: MHz

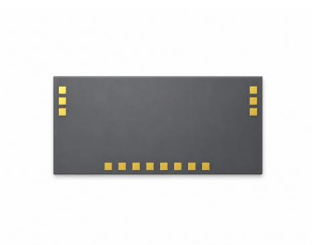
移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

移相均方根误差: 最小值: 0.5; 典型值: 0.7; 最大值: 1; 单位: °

移相附加调幅: 典型值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-5000-6000-6B

5000–6000 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 1 ° (典型值); 插入损耗: 7 dB (典型值); 移相范围: 5.625 ° (最小值) / 354.375 ° (最大值). 裸片尺寸: 3.1 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 5000; 最大值: 6000; 数值: 5000–6000; 单位: MHz

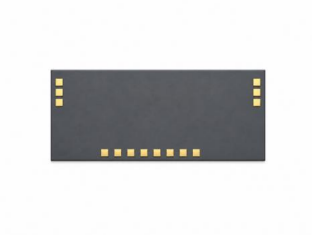
插入损耗: 典型值: 7; 单位: dB

移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

移相均方根误差: 典型值: 1; 单位: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

产品详情　产品规格书



LCI-PS-2700-3500-6B

2700–3500 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 1 ° (典型值); 插入损耗: 5.5 dB (典型值); 移相范围: 5.625 ° (最小值) / 354.375 ° (最大值). 裸片尺寸: 3.3 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 5.5; 单位: dB

移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

移相均方根误差: 典型值: 1; 单位: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

产品详情　产品规格书



LCI-PS-15000-23000-6B

15000–23000 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 1.4 ° (典型值); 插入损耗: 9.5 dB (典型值); 移相范围: 5.625 ° (最小值) / 354.375 ° (最大值). 裸片尺寸: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 15000; 最大值: 23000; 数值: 15000–23000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 9.5; 单位: dB

移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

移相均方根误差: 典型值: 1.4; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-25000-33000-6B

25000–33000 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 1.6 ° (典型值); 插入损耗: 9.5 dB (典型值); 移相范围: 5.625 ° (最小值) / 354.375 ° (最大值). 裸片尺寸: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 25000; 最大值: 33000; 数值: 25000–33000; 单位: MHz

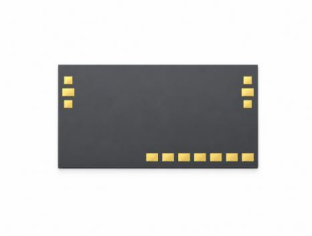
插入损耗: 典型值: 9.5; 单位: dB

移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

移相均方根误差: 典型值: 1.6; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 1.2 ° (典型值); 插入损耗: 7 dB (典型值); 移相范围: 5.625 ° (最小值) / 354.375 ° (最大值). 裸片尺寸: 2.5 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

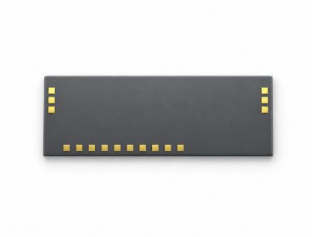
插入损耗: 典型值: 7; 单位: dB

移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

移相均方根误差: 典型值: 1.2; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-900-1400-6B-D

900–1400 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 1.5 ° (典型值); 插入损耗: 5 dB (典型值); 移相范围: 5.625 ° (最小值) / 354.375 ° (最大值). 裸片尺寸: 3.6 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 900; 最大值: 1400; 数值: 900–1400; 单位: MHz

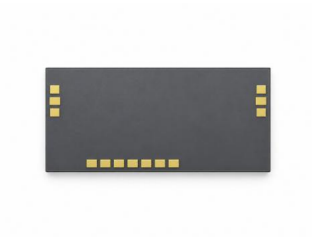
插入损耗: 典型值: 5; 单位: dB

移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

移相均方根误差: 典型值: 1.5; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-1200-1600-6B-D

1200–1600 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 0.8 ° (典型值); 插入损耗: 4.3 dB (典型值); 移相范围: 5.625 ° (最小值) / 354.375 ° (最大值). 裸片尺寸: 3.3 × 1.6 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 1200; 最大值: 1600; 数值: 1200–1600; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 4.3; 单位: dB

移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

移相均方根误差: 典型值: 0.8; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-2000-8000-6B

2000–8000 MHz 6位 GaAs MMIC 数控移相器裸片

移相均方根误差: 2.2 ° (典型值) / 3 ° (最大值); 插入损耗: 10 dB (典型值) / 11.5 dB (最大值); 移相范围: 5.625 ° (最小值) / 354.375 ° (最大值). 裸片尺寸: 5 × 1.75 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 8000; 数值: 2000–8000; 单位: MHz

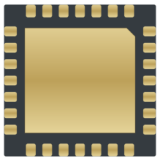
插入损耗: 典型值: 10; 最大值: 11.5; 单位: dB

移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

移相均方根误差: 典型值: 2.2; 最大值: 3; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-900-1400-6B-C

900–1400 MHz 数字移相器IC — 6-bit; RMS 1.5° (典型值)

900–1400 MHz; 64态移相均方根误差 1.5 ° (典型值); 移相附加调幅 ±0.4 dB (典型值); 输入驻波比 1.5 (典型值); 输出驻波比 1.4 (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 900; 最大值: 1400; 数值: 900–1400; 单位: MHz

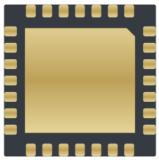
移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

插入损耗: 典型值: -5.4; 单位: dB

64态移相均方根误差: 典型值: 1.5; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-1200-1400-6B-C

1200–1400 MHz 数字移相器IC — 6-bit; RMS 0.7° (典型值)

1200–1400 MHz; 64态移相均方根误差 0.7 ° (典型值); 移相附加调幅 ±0.5 dB (典型值); 输入驻波比 1.4 (典型值); 输出驻波比 1.4 (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 1200; 最大值: 1400; 数值: 1200–1400; 单位: MHz

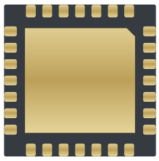
移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

插入损耗: 典型值: -5.4; 单位: dB

64态移相均方根误差: 典型值: 0.7; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-1200-1600-6B-C

1200–1600 MHz 数字移相器IC — 6-bit; RMS 0.8° (典型值)

1200–1600 MHz; 64态移相均方根误差 0.8 ° (典型值); 移相附加调幅 ±0.4 dB (典型值); 输入驻波比 1.4 (典型值); 输出驻波比 1.4 (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 1200; 最大值: 1600; 数值: 1200–1600; 单位: MHz

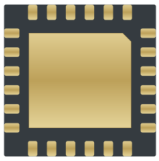
移相范围: 最小值: 5.625; 最大值: 354.375; 单位: °

插入损耗: 典型值: -4.7; 单位: dB

64态移相均方根误差: 典型值: 0.8; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-PS-14000-18000-6B-C

14000–18000 MHz 数字移相器IC — 6-bit; RMS 1.2° (典型值)

14000–18000 MHz; 64态移相均方根误差 1.2 ° (典型值); 移相附加调幅 ±0.3 dB (典型值); 输入驻波比 1.5 (典型值); 输出驻波比 1.3 (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

移相范围: 最小值: 5.625; 单位: °

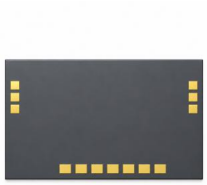
插入损耗: 典型值: -7.4; 单位: dB

64态移相均方根误差: 典型值: 1.2; 单位: °

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

数字射频衰减器芯片



LCI-ATT-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz 6位 GaAs MMIC 数控衰减器裸片

衰减均方根误差: 0.3 dB (典型值); 插入损耗: 4 dB (最大值); 衰减范围: 0.5 dB (最小值) / 31.5 dB (最大值). 裸片尺寸: 2.5 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

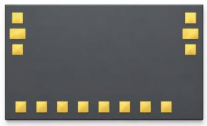
插入损耗: 最大值: 4; 单位: dB

衰减范围: 最小值: 0.5; 最大值: 31.5; 单位: dB

衰减均方根误差: 典型值: 0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-ATT-DC-8000-6B

DC–8000 MHz 6位 GaAs MMIC 数控衰减器裸片

衰减均方根误差: 0.2 dB (典型值); 插入损耗: 1.6 dB (典型值); 衰减范围: 0.5 dB (最小值) / 31.5 dB (最大值). 裸片尺寸: 1.9 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 8000; 数值: DC–8000; 单位: MHz

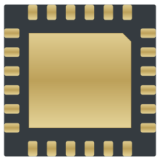
插入损耗: 典型值: 1.6; 单位: dB

衰减范围: 最小值: 0.5; 最大值: 31.5; 单位: dB

衰减均方根误差: 典型值: 0.2; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-ATT-100-8000-6B

100–8000 MHz 数字步进衰减器IC — 6-bit; 0.5 dB

100–8000 MHz; 衰减范围 0.5–31.5 dB; 衰减精度 0.2 dB (典型值); 插入损耗 2 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 100; 最大值: 8000; 数值: 100–8000; 单位: MHz

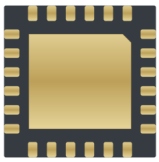
插入损耗: 典型值: 2; 单位: dB

衰减范围: 最小值: 0.5; 最大值: 31.5; 单位: dB

衰减精度: 典型值: 0.2; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-ATT-14000-18000-6B-C

14000–18000 MHz 数字步进衰减器IC — 6-bit; 0.5 dB

14000–18000 MHz; 衰减范围 0.5–31.5 dB; 衰减精度 0.3 dB (典型值); 插入损耗 2 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 14000; 最大值: 18000; 数值: 14000–18000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 2; 单位: dB

衰减范围: 最小值: 0.5; 最大值: 31.5; 单位: dB

衰减精度: 典型值: 0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-TTD-5000-6000-4B

5000–6000 MHz 4位 GaAs MMIC 数控延时裸片

时间延迟: 92.5 ps (典型值) (T1; t_nom = 92.59 ps); 时间延迟: 737 ps (典型值) (T4; t_nom = 740.74 ps); 插入损耗: 12 dB (典型值) / 13 dB (最大值). 裸片尺寸: 4.5 × 4 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 5000; 最大值: 6000; 数值: 5000–6000; 单位: MHz

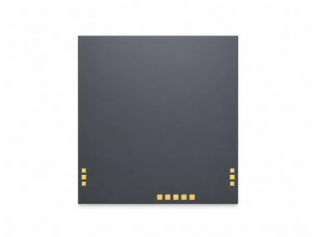
插入损耗: 典型值: 12; 最大值: 13; 单位: dB

时间延迟 (T1): 典型值: 92.5; 数值: T1; t_nom = 92.59 ps; 单位: ps

时间延迟 (T2): 典型值: 184; 数值: T2; t_nom = 185.185 ps; 单位: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

产品详情　产品规格书



LCI-TTD-8500-10500-4B

8500–10500 MHz 4位 GaAs MMIC 数控延时裸片

时间延迟: 52.7 ps (典型值) (T1; t_nom = 52 ps); 时间延迟: 416 ps (典型值) (T4; t_nom = 416 ps); 插入损耗: 12 dB (典型值) / 13 dB (最大值). 裸片尺寸: 4 × 4.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8500; 最大值: 10500; 数值: 8500–10500; 单位: MHz

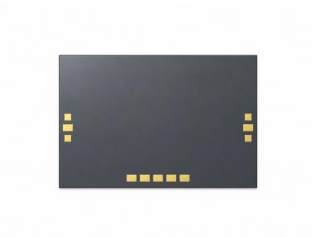
插入损耗: 典型值: 12; 最大值: 13; 单位: dB

时间延迟 (T1): 典型值: 52.7; 数值: T1; t_nom = 52 ps; 单位: ps

时间延迟 (T2): 典型值: 102; 数值: T2; t_nom = 104 ps; 单位: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

产品详情　产品规格书



LCI-TTD-8000-12000-3B

8000–12000 MHz 3位 GaAs MMIC 数控延时裸片

时间延迟: 25 ps (典型值) (T1; t_nom = 25 ps); 时间延迟: 102 ps (典型值) (T3; t_nom = 100 ps); 插入损耗: 6 dB (典型值) / 7 dB (最大值). 裸片尺寸: 3 × 2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

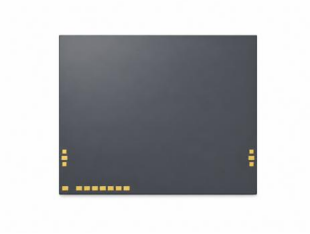
插入损耗: 典型值: 6; 最大值: 7; 单位: dB

时间延迟 (T1): 典型值: 25; 数值: T1; t_nom = 25 ps; 单位: ps

时间延迟 (T2): 典型值: 49.5; 数值: T2; t_nom = 50 ps; 单位: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

产品详情　产品规格书



LCI-TTD-200-2000-6B

200–2000 MHz 6位 GaAs MMIC 数控延时裸片

时间延迟: 25 ps (典型值) (T1; t_nom = 25 ps); 时间延迟: 800 ps (典型值) (T6; t_nom = 800 ps); 插入损耗: 11 dB (最大值). 裸片尺寸: 5 × 4 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 200; 最大值: 2000; 数值: 200–2000; 单位: MHz

插入损耗: 最大值: 11; 单位: dB

时间延迟 (T1): 典型值: 25; 单位: ps; 备注: T1; t_nom = 25 ps

时间延迟 (T2): 典型值: 50; 单位: ps; 备注: T2; t_nom = 50 ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

产品详情　产品规格书



LCI-TTD-7000-13000-3B

7000–13000 MHz 3位 GaAs MMIC 数控延时裸片

时间延迟: 52 ps (典型值) (T1; t_nom = 52 ps); 时间延迟: 208 ps (典型值) (T3; t_nom = 208 ps); 插入损耗: 9 dB (典型值). 裸片尺寸: 2.5 × 2.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 7000; 最大值: 13000; 数值: 7000–13000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 9; 单位: dB

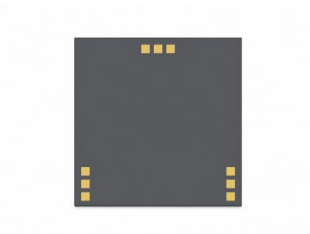
时间延迟 (T1): 典型值: 52; 数值: T1; t_nom = 52 ps; 单位: ps

时间延迟 (T2): 典型值: 104; 数值: T2; t_nom = 104 ps; 单位: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

产品详情　产品规格书

集成无源射频器件



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 2 × 2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 18000; 数值: 2000–18000; 单位: MHz

隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 3700; 最大值: 5000; 数值: 3700–5000; 单位: MHz

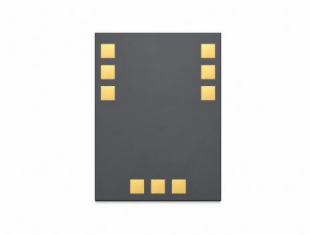
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 14 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 500; 最大值: 2700; 数值: 500–2700; 单位: MHz

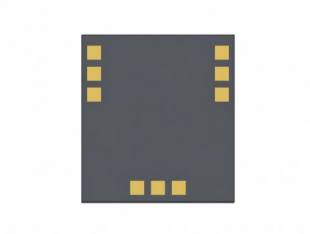
隔离度: 典型值: 14; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 18 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 800; 最大值: 2000; 数值: 800–2000; 单位: MHz

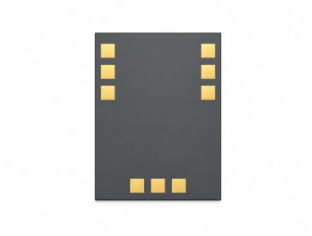
隔离度: 典型值: 18; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 18 dB (典型值); 输入驻波比: 1.4 (典型值); 输出驻波比: 1.4 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 1000; 最大值: 4000; 数值: 1000–4000; 单位: MHz

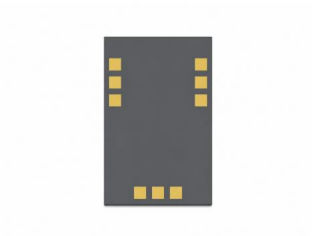
隔离度: 典型值: 18; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.4

输出驻波比: 典型值: 1.4

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

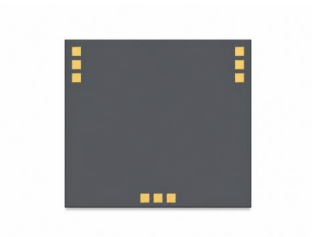
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 18000; 数值: 2000–18000; 单位: MHz

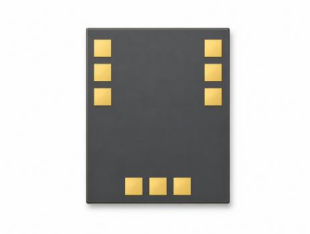
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 30 dB (典型值); 输入驻波比: 1.1 (典型值); 输出驻波比: 1.1 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

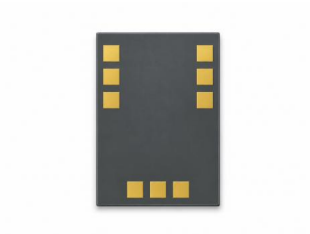
隔离度: 典型值: 30; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.1

输出驻波比: 典型值: 1.1

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 25 dB (典型值); 输入驻波比: 1.1 (典型值); 输出驻波比: 1.1 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 5000; 最大值: 7000; 数值: 5000–7000; 单位: MHz

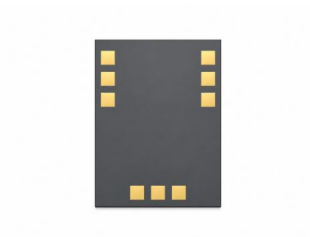
隔离度: 典型值: 25; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.1

输出驻波比: 典型值: 1.1

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 25 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 5000; 最大值: 13000; 数值: 5000–13000; 单位: MHz

隔离度: 典型值: 25; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

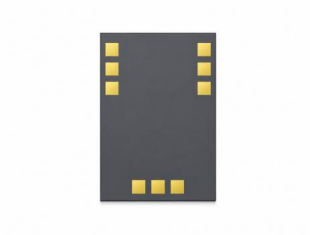
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 25 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 7000; 最大值: 13000; 数值: 7000–13000; 单位: MHz

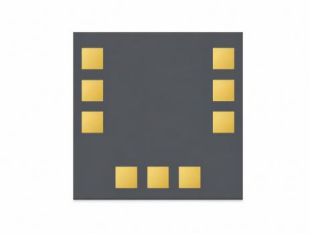
隔离度: 典型值: 25; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.1 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

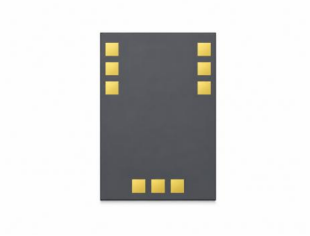
隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.1

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 30 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.2 (典型值). 裸片尺寸: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 10000; 最大值: 20000; 数值: 10000–20000; 单位: MHz

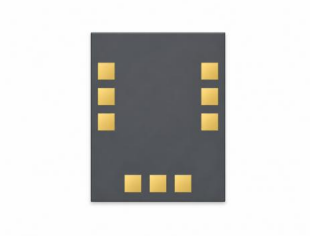
隔离度: 典型值: 30; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 25 dB (典型值); 输入驻波比: 1.2 (典型值); 输出驻波比: 1.1 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 12000; 最大值: 18000; 数值: 12000–18000; 单位: MHz

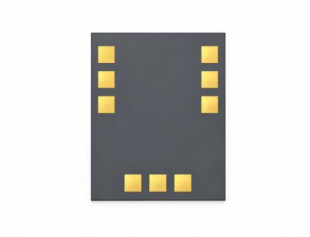
隔离度: 典型值: 25; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2

输出驻波比: 典型值: 1.1

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz GaAs IPD 2路0°功分器裸芯片

隔离度: 20 dB (典型值); 输入驻波比: 1.3 (典型值); 输出驻波比: 1.3 (典型值). 裸片尺寸: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 30000; 最大值: 40000; 数值: 30000–40000; 单位: MHz

隔离度: 典型值: 20; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 0 dB; 输入/输出驻波比: 1.2 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 0; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.2

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 1 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 1; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 2 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 2; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 3 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 3; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz 4 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 4 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 4; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 8 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.3 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 8; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz 16 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 16 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.3 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 16; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 0 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.6 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 0; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.6; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 1 dB; 输入/输出驻波比: 1.4 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 1; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.4

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 2 dB; 输入/输出驻波比: 1.35 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 2; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.35

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 3 dB; 输入/输出驻波比: 1.35 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 3; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.35

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz 5 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 5 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 5; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz 6 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 6 dB; 输入/输出驻波比: 1.35 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 6; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.35

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 8 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.3 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 8; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz 10 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 10 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

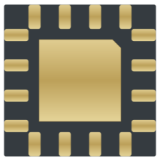
衰减量: 数值: 10; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCXOV-DC-40000-C

DC–40000 MHz 封装射频交叉跳线器 — ISO 30 dB (典型值)

DC–40000 MHz; 插入损耗 -1.4 dB (典型值); 隔离度 30 dB (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: DC; 最大值: 40000; 数值: DC–40000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: -1.4; 单位: dB

隔离度: 典型值: 30; 单位: dB

输入/输出驻波比: 典型值: 1.2

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

混频与变频芯片



LCI-MIX-500-2000-D

500–2000 MHz GaAs MMIC 无源双平衡混频器裸片

变频损耗: 9 dB (典型值); 本振功率: 15 dBm; 工作频率 (IF): 0 MHz (最小值) / 900 MHz (最大值) / DC–900 MHz. 裸片尺寸: 2.1 × 1.45 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 500; 最大值: 2000; 数值: 500–2000 (RF / LO); 单位: MHz

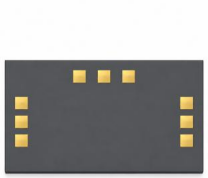
工作频率 (IF): 最小值: 0; 最大值: 900; 数值: DC–900; 单位: MHz

变频损耗: 典型值: 9; 单位: dB

隔离度 (LO / RF): 典型值: 45; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-MIX-7000-10000-D

7000–10000 MHz GaAs MMIC 无源双平衡混频器裸片

变频损耗: 8.5 dB (典型值); 本振功率: 14 dBm; 工作频率 (IF): 1400 MHz (最小值) / 3000 MHz (最大值) / 1400–3000 MHz. 裸片尺寸: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 7000; 最大值: 10000; 数值: 7000–10000 (RF); 单位: MHz

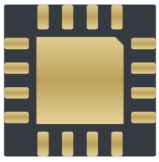
工作频率 (LO): 最小值: 5000; 最大值: 9000; 数值: 5000–9000; 单位: MHz

工作频率 (IF): 最小值: 1400; 最大值: 3000; 数值: 1400–3000; 单位: MHz

变频损耗: 典型值: 8.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-MIX-500-2000-C

500–2000 MHz 封装无源双平衡混频器 — LO +14 dBm; IL -9 dB (典型值)

500–2000 MHz; IF DC–900 MHz; 变频损耗 -9 dB (典型值); LOin = 14 dBm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 500; 最大值: 2000; 数值: 500–2000; 单位: MHz

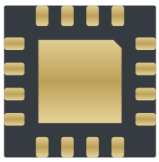
中频频率范围: 最小值: DC; 最大值: 900; 单位: MHz

变频损耗: 符号: IL; 典型值: -9; 单位: dB

LO–RF隔离度: 符号: ISOL-R; 典型值: -40; 单位: dB

TA = +25 °C; LOin = 14 dBm; RFin = -10 dBm

产品详情　产品规格书



LCI-MIX-7000-10000-C

7000–10000 MHz 封装无源双平衡混频器 — LO +14 dBm; IL -9 dB (典型值)

7000–10000 MHz; IF 1400–3400 MHz; 变频损耗 -9 dB (典型值); LOin = 14 dBm.

工作频率: 符号: f; 最小值: 7000; 最大值: 10000; 数值: 7000–10000; 单位: MHz

中频频率范围: 最小值: 1400; 最大值: 3400; 单位: MHz

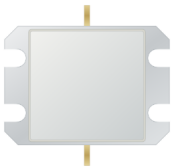
变频损耗: 符号: IL; 典型值: -9; 单位: dB

LO–RF隔离度: 符号: ISOL-R; 典型值: -40; 单位: dB

TA = +25 °C; LOin = 14 dBm; RFin = -10 dBm

产品详情　产品规格书

RF 功率晶体管



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 51 dBm (典型值)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (典型值); 功率增益 11 dB (典型值); PAE 45 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 5700; 最大值: 7100; 数值: 5700–7100; 单位: MHz

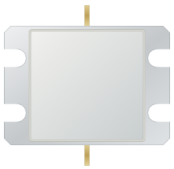
饱和输出功率: 最小值: 50.5; 典型值: 51; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 10.5; 典型值: 11; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 40; 典型值: 45; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

产品详情　产品规格书



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 56.5 dBm (典型值)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (典型值); 功率增益 13.5 dB (典型值); PAE 55 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

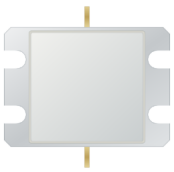
饱和输出功率: 最小值: 56; 典型值: 56.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 13; 典型值: 13.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 50; 典型值: 55; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

产品详情　产品规格书



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 56.5 dBm (典型值)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (典型值); 功率增益 12.5 dB (典型值); PAE 45 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 5300; 最大值: 5900; 数值: 5300–5900; 单位: MHz

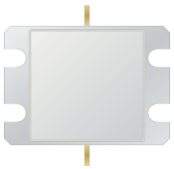
饱和输出功率: 最小值: 56; 典型值: 56.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 12; 典型值: 12.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 40; 典型值: 45; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

产品详情　产品规格书



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 48.5 dBm (典型值)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (典型值); 功率增益 12.5 dB (典型值); PAE 50 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3900; 数值: 2700–3900; 单位: MHz

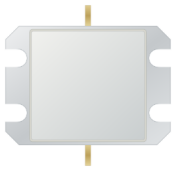
饱和输出功率: 最小值: 48; 典型值: 48.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 12; 典型值: 12.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 45; 典型值: 50; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

产品详情　产品规格书



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 53.5 dBm (典型值)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (典型值); 功率增益 13.5 dB (典型值); PAE 65 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2700; 最大值: 3500; 数值: 2700–3500; 单位: MHz

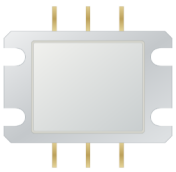
饱和输出功率: 最小值: 53; 典型值: 53.5; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 13; 典型值: 13.5; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 60; 典型值: 65; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

产品详情　产品规格书



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 50 dBm (典型值)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (典型值); 功率增益 12 dB (典型值); PAE 50 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2300; 最大值: 3900; 数值: 2300–3900; 单位: MHz

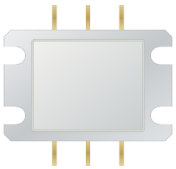
饱和输出功率: 最小值: 49; 典型值: 50; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 11; 典型值: 12; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 45; 典型值: 50; 单位: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

产品详情　产品规格书



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 49 dBm (典型值)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (典型值); 功率增益 13 dB (典型值); PAE 50 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 2600; 最大值: 3700; 数值: 2600–3700; 单位: MHz

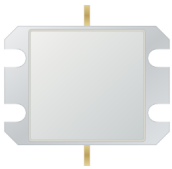
饱和输出功率: 最小值: 48; 典型值: 49; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 12; 典型值: 13; 单位: dB

功率附加效率: 最小值: 45; 典型值: 50; 单位: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

产品详情　产品规格书



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 51 dBm (典型值)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (典型值); 功率增益 9 dB (典型值); PAE 38 % (典型值).

工作频率: 符号: f; 最小值: 8500; 最大值: 9600; 数值: 8500–9600; 单位: MHz

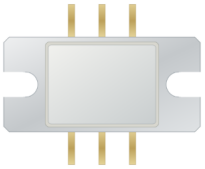
饱和输出功率: 最小值: 50; 典型值: 51; 单位: dBm

功率增益: 最小值: 8; 典型值: 9; 单位: dB

功率附加效率: 典型值: 38; 单位: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

产品详情　产品规格书



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (典型值)

2000–6000 MHz; 参考输出功率 45.51 dBm (典型值); 功率增益 19.51 dB (典型值); 漏极效率 39.82 % (典型值) @ 6000 MHz.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

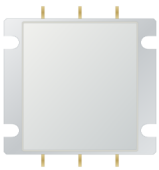
参考输出功率: 典型值: 45.51; 单位: dBm; 备注: f = 6000 MHz

功率增益: 典型值: 19.51; 单位: dB; 备注: f = 6000 MHz

漏极效率: 符号: ηD; 典型值: 39.82; 单位: %; 备注: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

产品详情　产品规格书



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (典型值)

700–6200 MHz; 饱和输出功率 49 dBm (典型值); 功率增益 7 dB (典型值); 漏极效率 35 % (典型值) @ 6000 MHz.

工作频率: 符号: f; 最小值: 700; 最大值: 6200; 数值: 700–6200; 单位: MHz

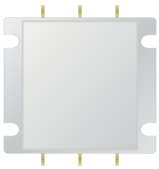
饱和输出功率: 符号: Psat; 典型值: 49; 单位: dBm; 备注: f = 6000 MHz

功率增益: 典型值: 7; 单位: dB; 备注: f = 6000 MHz

漏极效率: 符号: ηD; 典型值: 35; 单位: %; 备注: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

产品详情　产品规格书



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (典型值)

2000–6200 MHz; 参考输出功率 50.1 dBm (典型值); 功率增益 8.6 dB (典型值); 漏极效率 52.4 % (典型值) @ 6000 MHz.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6200; 数值: 2000–6200; 单位: MHz

参考输出功率: 典型值: 50.1; 单位: dBm; 备注: f = 6000 MHz

功率增益: 典型值: 8.6; 单位: dB; 备注: f = 6000 MHz

漏极效率: 符号: ηD; 典型值: 52.4; 单位: %; 备注: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

产品详情　　产品规格书

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。